ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ

ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И БУКВЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ

ГОСТ 19480—89
(СТ СЭВ 1817—88, СТ СЭВ 4755—84,
СТ СЭВ 4756—84)

Издание официальное

1 р. 10 коп. БЗ 12—89/1048

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО УПРАВЛЕНИЮ
КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ
Москва

gost.e-ecolog.ru

УДК 621.382.82:001.4:006.354 Группа Э00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ

Термины, определения и буквенные обозначения электрических параметров

Integrated circuits. Terms, definitions and letter symbols of electrical parameters

ГОСТ 19480—89

(СТ СЭВ 1817—88, СТ СЭВ 4755—84, СТ СЭВ 4756—84)

ОКСТУ 6301

Дата введения 01.01.91

Настоящий стандарт устанавливает термины, определения и буквенные обозначения электрических параметров интегральных микросхем.

Термины и буквенные обозначения, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения во всех видах документации и литературы, входящих в сферу работ по стандартизации или использующих результаты этих работ.

Международные буквенные обозначения обязательны для применения в технической документации, предназначенной для экспортных поставок.

1. Стандартизованные термины с определениями и буквенные обозначения приведены в табл. 1.

2. Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.

Применение терминов — синонимов стандартизованного термина не допускается. Недопустимые к применению термины-синонимы приведены в табл. 1 в качестве справочных и обозначены пометой «Ндп».

2.1. Для отдельных стандартизованных терминов в табл. 1 приведены в качестве справочных краткие формы, которые разрешается применять в случаях, исключающих возможность их различного толкования.

2.2. Приведенные определения можно, при необходимости, изменять, вводя в них производные признаки, раскрывая значения используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем определяемого понятия. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в данном стандарте.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

★

© Издательство стандартов, 1990

2.3. В случаях, когда в термине содержатся все необходимые и достаточные признаки понятия, определение не приведено и в графе «Определение» поставлен прочерк.

2.4. В табл. 1 в качестве справочных приведены иноязычные эквиваленты для ряда стандартизованных терминов на английском (E) и французском (F) языках.

3. Алфавитные указатели содержащихся в стандарте терминов на русском языке и их иноязычных эквивалентов приведены в табл. 2—4.

4. Методика образования буквенных обозначений производных параметров приведена в приложении.

5. Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткая форма — светлым, а недопустимые синонимы — курсивом.

Таблица 1

Термин	Буквенное обозначение		Определение
	отечественное	международное	
ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ			
1. **Параметр интегральной микросхемы** Параметр	X	X	Величина, характеризующая свойства или режимы работы интегральной микросхемы
2. **Номинальное значение параметра интегральной микросхемы** Номинальное значение параметра	$X_{ном}$	X_{nom}	Значение параметра интегральной микросхемы, заданное в нормативно-технической документации и являющееся исходным для отсчета отклонений
3. **Диапазон значений параметра интегральной микросхемы** Диапазон значений параметра	δX	—	Область, в которую укладываются значения параметров всех интегральных микросхем данного типа или партии однотипных интегральных микросхем при заданном уровне доверительной вероятности
4. **Допустимый диапазон значений параметра интегральной микросхемы** Допустимый диапазон значений параметра	$\delta X_{доп}$	—	Разброс значений параметра интегральной микросхемы, указанной в нормативно-технической документации
5. **Отклонение параметра интегральной микросхемы** Отклонение параметра	ΔX	—	Разность между действительным значением параметра интегральной микросхемы и его номинальным значением

Продолжение табл. 1

Термин	Буквенное обозначение		Определение
	отечественное	международное	
6. **Относительное отклонение параметра интегральной микросхемы** Относительное отклонение параметра	$\Delta X_{отн}$	—	Отношение отклонения параметра интегральной микросхемы к его номинальному значению
7. **Напряжение (ток) управления интегральной микросхемы** Напряжение (ток) управления	$X_{упр}$	—	Напряжение (ток) управляющее функциональным назначением интегральной микросхемы
8. **Температурный коэффициент параметра интегральной микросхемы** Температурный коэффициент параметра	α_X	α_X	Отношение изменения параметра интегральной микросхемы к вызвавшему его изменению температуры окружающей среды
9. **Нестабильность параметра интегральной микросхемы** Нестабильность параметра	$\Delta X_{нст}$	—	Отношение относительного отклонения параметра интегральной микросхемы к вызвавшему его дестабилизирующему фактору
10. **Максимальное значение параметра интегральной микросхемы** Максимальное значение параметра	X_{max}	X_{max}	Наибольшее значение параметра интегральной микросхемы, при котором заданные параметры соответствуют заданным значениям
11. **Минимальное значение параметра интегральной микросхемы** Минимальное значение параметра	X_{min}	X_{min}	Наименьшее значение параметра интегральной микросхемы, при котором заданные параметры соответствуют заданным значениям
ПАРАМЕТРЫ, ОБЩИЕ ДЛЯ ЦИФРОВЫХ И АНАЛОГОВЫХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ			
12. **Напряжение питания интегральной микросхемы** Напряжение питания	$U_п$	U_{CC}	Значение напряжения на выводах питания интегральной микросхемы
13. **Входное напряжение интегральной микросхемы** Входное напряжение	$U_{вх}$	U_I	Напряжение на входе интегральной микросхемы в заданном режиме
14. **Выходное напряжение интегральной микросхемы** Выходное напряжение	$U_{вых}$	U_O	Напряжение на выходе интегральной микросхемы в заданном режиме

Продолжение табл. 1

Термин	Буквенное обозначение		Определение
	отечественное	международное	
15. **Напряжение срабатывания интегральной микросхемы** Напряжение срабатывания	$U_{срб}$	U_{IT+} U_{ITP}	Наименьшее постоянное напряжение на входе, при котором происходит переход интегральной микросхемы из одного устойчивого состояния в другое
16. **Напряжение отпускания интегральной микросхемы** Напряжение отпускания	$U_{отп}$	U_{IT-} U_{ITN}	Наибольшее постоянное напряжение на входе, при котором происходит переход интегральной микросхемы из одного устойчивого состояния в другое
17. **Входной ток интегральной микросхемы** Входной ток	$I_{вх}$	I_I	Ток, протекающий во входной цепи интегральной микросхемы в заданном режиме
18 **Выходной ток интегральной микросхемы** Выходной ток	$I_{вых}$	I_O	Ток, протекающий в цепи нагрузки интегральной микросхемы в заданном режиме
19. **Ток утечки интегральной микросхемы** Ток утечки	$I_{ут}$	I_L	Ток в цепи интегральной микросхемы при закрытом состоянии цепи и заданных режимах на остальных выводах
20 **Ток потребления интегральной микросхемы** Ток потребления	$I_{пот}$	I_{CC}	Ток, потребляемый интегральной микросхемой от источников питания в заданном режиме
21. **Ток короткого замыкания интегральной микросхемы** Ток короткого замыкания E. Short-circuit current F. Courant de court-circuit	$I_{кз}$	I_{OS}	Выходной ток интегральной микросхемы при закороченном выходе
22. **Потребляемая мощность интегральной микросхемы** Потребляемая мощность	$P_{пот}$	P_{CC}	Мощность, потребляемая интегральной микросхемой, работающей в заданном режиме, от соответствующего источника питания
23. **Рассеиваемая мощность интегральной микросхемы** Рассеиваемая мощность	$P_{рас}$	P_{tot}	Мощность, рассеиваемая интегральной микросхемой, работающей в заданном режиме

Продолжение табл. 1

Термин	Буквенное обозначение		Определение
	отечественное	международное	
24. **Входное сопротивление интегральной микросхемы** Входное сопротивление	$R_{вх}$	R_I	Отношение приращения входного напряжения интегральной микросхемы к приращению активной составляющей входного тока при заданной частоте сигнала
25. **Выходное сопротивление интегральной микросхемы** Выходное сопротивление	$R_{вых}$	R_O	Отношение приращения выходного напряжения интегральной микросхемы к вызвавшему его приращению активной составляющей выходного тока при заданной частоте сигнала
26. **Сопротивление нагрузки интегральной микросхемы** Сопротивление нагрузки	$R_н$	R_L	Суммарное активное сопротивление внешних цепей, подключенных к выходу интегральной микросхемы
27. **Входная емкость интегральной микросхемы** Входная емкость	$C_{вх}$	C_I	Отношение емкостной реактивной составляющей входного тока интегральной микросхемы к произведению синусоидального входного напряжения, вызвавшего этот ток, и его круговой частоты
28. **Выходная емкость интегральной микросхемы** Выходная емкость	$C_{вых}$	C_O	Отношение емкостной реактивной составляющей выходного тока интегральной микросхемы к произведению синусоидального выходного напряжения, вызванного этим током, и его круговой частоты
29. **Емкость нагрузки интегральной микросхемы** Емкость нагрузки	$C_н$	C_L	Суммарная емкость внешних цепей, подключенных к выходу интегральной микросхемы
30. **Время нарастания сигнала интегральной микросхемы** Время нарастания сигнала E. Rise time G. Temps de croissance	$t_{нар}$	t_r	Интервал времени нарастания сигнала от уровня 0,1 до момента, когда выходной сигнал интегральной микросхемы впервые достигнет заданного значения, близкого к его окончательному значению при ступенчатом изменении уровня входного сигнала

Продолжение табл. 1

Термин	Буквенное обозначение: отечественное	Буквенное обозначение: международное	Определение
31. Время спада сигнала интегральной микросхемы Время спада сигнала E. Fall time F. Temps de decroissance	$t_{сп}$	t_f	Интервал времени спада сигнала от уровня 0,9 до момента, когда выходной сигнал интегральной микросхемы впервые достигнет заданного значения, близкого к его окончательному значению при ступенчатом изменении уровня входного сигнала
32. Длительность фронта входного сигнала интегральной микросхемы Длительность фронта входного сигнала	$\tau_ф$	—	Интервал времени нарастания амплитуды импульса входного сигнала интегральной микросхемы от уровня 0,1 до уровня 0,9 от номинального значения
33. Длительность спада входного сигнала интегральной микросхемы Длительность спада входного сигнала	$\tau_{сп}$	—	Интервал времени убывания амплитуды импульса входного сигнала интегральной микросхемы от уровня 0,9 до уровня 0,1 от номинального значения
34. Чувствительность интегральной микросхемы Чувствительность	S	—	Наименьшее значение входного напряжения, при котором электрические параметры интегральной микросхемы соответствуют заданным значениям

ПАРАМЕТРЫ, ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ АНАЛОГОВЫХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ

35. Входное напряжение покоя интегральной микросхемы Входное напряжение покоя	$U_{вхт}$	U_{IO}	Постоянное напряжение на входе интегральной микросхемы с невключенным входом или с нулевым входным сигналом
36. Выходное напряжение покоя интегральной микросхемы Выходное напряжение покоя	$U_{вых}$	U_{OQ}	Постоянное напряжение на выходе интегральной микросхемы с невключенным входом или с нулевым входным сигналом
37. Коммутируемое напряжение интегральной микросхемы Напряжение коммутируемое	$U_{ком}$	U_S	Напряжение, подаваемое на вход коммутирующего элемента интегральной микросхемы

Продолжение табл. 1

Термин	Буквенное обозначение		Определение
	отечественное	международное	
38. **Напряжение смещения нуля интегральной микросхемы** Напряжение смещения нуля E. Input offset voltage F. Tension de décalage	$U_{см}$	U_{IO}	Постоянное напряжение, которое должно быть приложено ко входу интегральной микросхемы, чтобы выходное напряжение было равно нулю или другому заданному значению
39. **Напряжение шума на выходе интегральной микросхемы** Напряжение шума на выходе E. Output noise voltage F. Tension de bruit en sortie	$U_{ш.вых}$	U_{no}	Напряжение собственного шума на выходе интегральной микросхемы
40. **Приведенное ко входу напряжение шума интегральной микросхемы** Приведенное ко входу напряжение шума	$U_{ш\ вх}$	U_{ln}	Отношение напряжения собственного шума на выходе интегральной микросхемы при заданных условиях к коэффициенту усиления напряжения
41. **Синфазные входные напряжения интегральной микросхемы** Синфазные входные напряжения	$U_{сф.вх}$	U_{IC}	Напряжения между каждым из входов интегральной микросхемы и общим выводом, амплитуды, фазы и временное распределение которых совпадают
42. **Входное напряжение ограничения интегральной микросхемы** Входное напряжение ограничения	$U_{огр.вх}$	$U_{I\,lim}$	Наименьшее значение входного напряжения интегральной микросхемы, при котором отклонение от линейности выходного напряжения превышает установленную величину
43. **Остаточное напряжение интегральной микросхемы** Остаточное напряжение	$U_{ост}$	U_{DS}	Напряжение между входом и выходом интегральной микросхемы при включенном канале и заданном значении коммутируемого тока
44. **Разность входных токов интегральной микросхемы** Разность входных токов	$\Delta I_{вх}$	I_{IO}	Разность значений токов, протекающих через дифференциальный вход интегральной микросхемы в заданном режиме
45. **Средний входной ток интегральной микросхемы** Средний входной ток	$I_{вх.ср}$	$I_{I\,AV}$	Среднее квадратическое значение входных токов интегральной микросхемы

Продолжение табл. 1

Термин	Буквенное обозначение: отечественное	Буквенное обозначение: международное	Определение
46. **Коммутируемый ток интегральной микросхемы** Коммутируемый ток	$I_{ном}$	I_S	Ток, протекающий через коммутирующий элемент интегральной микросхемы в замкнутом состоянии ключа
47. **Выходная мощность интегральной микросхемы** Выходная мощность	$P_{вых}$	P_O	Мощность, выделяемая на нагрузке интегральной микросхемы в заданном режиме
48. **Нижняя граничная частота полосы пропускания интегральной микросхемы** Нижняя граничная частота полосы пропускания	$f_н$	f_L	Наименьшее значение частоты, на которой коэффициент усиления напряжения интегральной микросхемы уменьшается на 3 дБ от значения на заданной частоте
49. **Верхняя граничная частота полосы пропускания интегральной микросхемы** Верхняя граничная частота полосы пропускания	$f_в$	f_H	Наибольшее значение частоты, на которой коэффициент усиления напряжения интегральной микросхемы уменьшается на 3 дБ от значения на заданной частоте
50. **Частота коммутации интегральной микросхемы** Частота коммутации	$f_{ком}$	f_S	Частота, с которой интегральная микросхема коммутирует ток
51. **Центральная частота полосы пропускания интегральной микросхемы** Центральная частота полосы пропускания	$f_ц$	f_o	Частота, равная полусумме нижней и верхней граничных частот полосы пропускания интегральной микросхемы
52. **Полоса пропускания интегральной микросхемы** Полоса пропускания	Δf	BW	Диапазон частот, в пределах которого коэффициент усиления интегральной микросхемы не падает ниже 3 дБ по сравнению с усилением на заданной частоте внутри этого диапазона
53. **Полоса задерживания интегральной микросхемы** Полоса задерживания	$\Delta f_{зд}$	Δf_d	Диапазон частот между верхней и нижней частотами полосы задерживания интегральной микросхемы

Продолжение табл. 1

Термин	Буквенное обозначение		Определение
	отечественное	международное	
54. **Нижняя частота полосы задерживания интегральной микросхемы** Нижняя частота полосы задерживания	$f_{зд.н}$	f_{dL}	Наименьшее значение частоты, на которой коэффициент усиления интегральной микросхемы уменьшается в заданное число раз от значения на заданной частоте
55. **Верхняя частота полосы задерживания интегральной микросхемы** Верхняя частота полосы задерживания	$f_{зд.в}$	f_{dH}	Наибольшее значение частоты, на которой коэффициент усиления интегральной микросхемы уменьшается в заданное число раз от значения на заданной частоте
56. **Частота единичного усиления интегральной микросхемы** Частота единичного усиления Идп. *Полоса единичного усиления* E. Frequency of unity (open loop) amplification F. Fréquence pour l'amplification unité	f_1	f_1	Частота, на которой модуль коэффициента усиления напряжения интегральной микросхемы при разомкнутой цепи обратной связи равен единице
57. **Частота входного сигнала интегральной микросхемы** Частота входного сигнала	$f_{вх}$	f_1	Частота, на которой производят измерение параметров интегральной микросхемы или ее эксплуатацию
58. **Частота генерирования интегральной микросхемы** Частота генерирования	$f_г$	f_g	—
59. **Время успокоения интегральной микросхемы** Время успокоения E. Ripple time F. Temps de vacillement	$t_{усп}$	t_{rip}	Интервал времени с момента достижения выходным напряжением интегральной микросхемы уровня 0,9 до момента последнего пересечения выходным напряжением заданного уровня
60. **Время задержки импульса интегральной микросхемы** Время задержки E. Delay time F. Temps de délai	$t_{зд}$	t_d	Интервал времени между нарастаниями входного и выходного импульсов интегральной микросхемы, измеренный на уровне 0,1 или на заданном уровне напряжения или тока

Продолжение табл. 1

Термин	Буквенное обозначение: отечественное	Буквенное обозначение: международное	Определение
61. **Коэффициент усиления напряжения интегральной микросхемы** Коэффициент усиления напряжения	K_{yU}	A_U	Отношение выходного напряжения интегральной микросхемы к входному напряжению
62. **Коэффициент усиления тока интегральной микросхемы** Коэффициент усиления тока	K_{yI}	A_I	Отношение выходного тока интегральной микросхемы к входному току
63. **Коэффициент усиления мощности интегральной микросхемы** Коэффициент усиления мощности	K_{yP}	A_P	Отношение выходной мощности интегральной микросхемы к входной мощности
64. **Коэффициент усиления синфазных входных напряжений интегральной микросхемы** Коэффициент усиления синфазных входных напряжений E. Common-mode voltage amplification F. Amplification en tension en mode commun	$K_{y.сф}$	A_{UC}	Отношение выходного напряжения интегральной микросхемы к синфазному входному напряжению
65. **Коэффициент ослабления синфазных входных напряжений интегральной микросхемы** Коэффициент ослабления синфазных входных напряжений E. Common-mode rejection ratio F. Taux de réjection en mode commun	$K_{ос.сф}$	K_{CMR}	Отношение коэффициента усиления напряжения интегральной микросхемы к коэффициенту усиления синфазных входных напряжений
66. **Коэффициент влияния нестабильности источников питания на напряжение смещения нуля интегральной микросхемы** Коэффициент влияния нестабильности источников питания на напряжение смещения нуля	$K_{нест.п}$	K_{SVR}	Отношение приращения напряжения смещения нуля интегральной микросхемы к вызвавшему его приращению напряжения источника питания

Продолжение табл. 1

Термин	Буквенное обозначение		Определение
	отечественное	международное	
67. **Коэффициент усиления дифференциального сигнала по напряжению интегральной микросхемы** Коэффициент усиления дифференциального сигнала по напряжению E. Differential-mode voltage amplification F. Amplification en tension en mode différentiel	$K_{U\,диф}$	A_{VD}	Отношение изменения значения выходного напряжения интегральной микросхемы к изменению значения напряжения на дифференциальном входе в заданном режиме
68. **Коэффициент гармоник интегральной микросхемы** Коэффициент гармоник	$K_г$	K_h	Отношение среднего квадратического напряжения суммы всех, кроме первой, гармоник сигнала интегральной микросхемы к среднему квадратическому напряжению суммы всех гармоник
69. **Диапазон автоматической регулировки усиления интегральной микросхемы** Диапазон АРУ	$U_{АРУ}$	AGC	Отношение наибольшего значения коэффициента усиления напряжения интегральной микросхемы к наименьшему его значению при изменении входного напряжения в заданных пределах
70. **Скорость нарастания выходного напряжения интегральной микросхемы** Скорость нарастания выходного напряжения Идп. *Скорость отслеживания*	$V_{U\,вых}$	$S_{UOM(SR)}$	Отношение изменения выходного напряжения с уровня 0,1 до уровня 0,9 к времени его нарастания при воздействии на вход интегральной микросхемы импульса напряжения прямоугольной формы
71. **Коэффициент прямоугольности амплитудно-частотной характеристики интегральной микросхемы** Коэффициент прямоугольности АЧХ	$K_п$	—	Отношение полосы частот интегральной микросхемы на уровне 0,01 или 0,001 к полосе пропускания на уровне 0,7
72. **Коэффициент пульсаций интегральной микросхемы** Коэффициент пульсаций	$K_{пз}$	—	Отношение амплитудного значения напряжения пульсаций интегральной микросхемы к значению постоянной составляющей напряжения

Продолжение табл. 1

Термин	Буквенное обозначение		Определение
	отечественное	международное	
73 **Коэффициент умножения частоты интегральной микросхемы** Коэффициент умножения частоты	$K_{умн\,f}$	—	Отношение частоты выходного сигнала интегральной микросхемы к частоте входного сигнала
74 **Коэффициент деления частоты интегральной микросхемы** Коэффициент деления частоты	$K_{дел\,f}$	—	Отношение частоты входного сигнала интегральной микросхемы к частоте выходного сигнала
75. **Крутизна преобразования интегральной микросхемы** Крутизна преобразования	$S_{пр6}$	—	Отношение выходного тока смесителя к вызвавшему его приращению входного напряжения при заданном напряжении гетеродина интегральной микросхемы

ПАРАМЕТРЫ, ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ ОПЕРАЦИОННЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ И КОМПАРАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ

76. **Максимальное выходное напряжение интегральной микросхемы** Максимальное выходное напряжение	$U_{вых\,max}$	U_{Omax}	Выходное напряжение интегральной микросхемы при заданном сопротивлении нагрузки и напряжении входного сигнала, когда его приращение не вызывает приращения выходного напряжения
77. **Напряжение шума интегральной микросхемы** Напряжение шума	$U_ш$	U_n	Напряжение на выходе интегральной микросхемы в заданной полосе частот при входном напряжении, равном нулю
78. **Эффективное напряжение шума интегральной микросхемы** Эффективное напряжение шума	$U_{ш.эф}$	$U_{n\,eff}$	Отношение шума на выходе, выраженного в эффективных значениях напряжения в заданной полосе частот, к коэффициенту усиления интегральной микросхемы
79. **Размах шума интегральной микросхемы** Размах шума	$\Delta U_ш$	U_{npp}	Разность между максимальными значениями пиков шума противоположного знака в заданной полосе частот на выходе интегральной микросхемы,

Продолжение табл. 1

Термин	Буквенное обозначение		Определение
	отечественное	международное	
			повторяющихся в заданном интервале времени при входном напряжении, равном нулю
80. **Нормированная электродвижущая сила шума интегральной микросхемы** Нормированная ЭДС шума	$E_{ш.н}$	E_{nN}	Отношение напряжения шума на выходе интегральной микросхемы в заданной полосе частот при включении между общим выводом и выводами входов резисторов, сопротивление которых стремится к нулю, к произведению коэффициента усиления на квадратный корень из полосы измеряемого шума
81. **Нормированный ток шума интегральной микросхемы** Нормированный ток шума	$I_{ш.н}$	I_{nN}	Отношение напряжения шума на выходе интегральной микросхемы в заданной полосе частот при включении между общим выводом и выводами входов резисторов заданного сопротивления к произведению коэффициента усиления на квадратный корень из полосы измеряемого шума
82. **Максимальная скорость нарастания выходного напряжения интегральной микросхемы** Максимальная скорость нарастания выходного напряжения	$V_{\text{вых max}}$	SR	Отношение изменения выходного напряжения с уровня 0,1 до уровня 0,9 к времени его нарастания при воздействии на вход интегральной микросхемы импульса прямоугольной формы максимального входного напряжения
83. **Частота среза интегральной микросхемы** Частота среза E. Open-loop cut-off frequency F. Fréquence de coupure en boucle ouverte	$f_{ср}$	f_{CO}	Частота, на которой модуль коэффициента усиления напряжения интегральной микросхемы при разомкнутой цепи обратной связи уменьшается до 0,707 значения на заданной частоте
84. **Частота полной мощности интегральной микросхемы** Частота полной мощности	f_P	f_P	Частота, на которой значение максимального выходного напряжения интегральной микросхемы

Продолжение табл. 1

Термин	Буквенное обозначение		Определение
	отечественное	международное	
			уменьшается на 3 дБ от значения на заданной частоте
85 **Время успокоения выходного напряжения интегральной микросхемы** Время успокоения выходного напряжения	$t_{успок}$	t_{tot}	Время с момента достижения входным импульсом прямоугольной формы уровня 0,5 до момента последнего пересечения выходным напряжением интегральной микросхемы заданной величины
86 **Коэффициент разделения каналов интегральной микросхемы** Коэффициент разделения каналов	$K_{разд}$	C_{dNG}	Отношение выходного напряжения интегральной микросхемы с сигналом на входе к выходному напряжению интегральной микросхемы при отсутствии входного сигнала
87. **Временной коэффициент входного тока интегральной микросхемы** Временной коэффициент входного тока	$\gamma_{Iвх}$	$\gamma_{IBI(IBI)}$	Отношение изменения входного тока интегральной микросхемы к вызвавшему его изменению времени
88. **Временной коэффициент разности входных токов интегральной микросхемы** Временной коэффициент разности входных токов	$\gamma_{\Delta Iвх}$	γ_{IIO}	Отношение изменения разности входных токов интегральной микросхемы к вызвавшему его изменению времени
89. **Временной коэффициент напряжения смещения нуля интегральной микросхемы** Временной коэффициент напряжения смещения нуля	γ_{UCM}	γ_{UIO}	Отношение изменения напряжения смещения нуля интегральной микросхемы к вызвавшему его изменению времени

ПАРАМЕТРЫ, ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ АНАЛОГОВЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ НИЗКОЙ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ

90. **Диапазон входных напряжений интегральной микросхемы** Диапазон входных напряжений E. Input voltage operating range	$\Delta U_{вх}$	ΔU_I	Интервал значений входного напряжения интегральной микросхемы от минимального значения до максимального

Продолжение табл. 1

Термин	Буквенное обозначение: отечественное	Буквенное обозначение: международное	Определение
F Domaine de fonctionnement de la tension d'entrée			
91. **Напряжение автоматической регулировки усиления интегральной микросхемы** Напряжение АРУ	$U_{АРУ}$	U_{AGC}	Напряжение на регулирующем входе интегральной микросхемы, обеспечивающее регулировку коэффициента усиления в заданных пределах
92. **Напряжение задержки автоматической регулировки усиления интегральной микросхемы** Напряжение задержки АРУ	$U_{зд\ АРУ}$	U_{AGCd}	Наибольшее абсолютное значение напряжения на управляющем входе интегральной микросхемы, при котором ее коэффициент усиления остается неизменным
93. **Напряжение пульсаций источника питания интегральной микросхемы** Напряжение пульсаций источника питания	$U_{оп.п}$	U_{ccr}	Значение переменной составляющей напряжения источника питания на выводах питания интегральной микросхемы
94. **Ток автоматической регулировки усиления интегральной микросхемы** Ток АРУ	$I_{АРУ}$	I_{AGC}	Ток, протекающий через регулирующий вход интегральной микросхемы и обеспечивающий регулировку коэффициента усиления в заданных пределах
95. **Частота резонанса интегральной микросхемы** Частота резонанса	f_0	f_0	Частота, на которой коэффициент усиления интегральной микросхемы принимает максимальное значение
96. **Частота квазирезонанса интегральной микросхемы** Частота квазирезонанса	$f_{кр}$	—	Частота, на которой коэффициент усиления интегральной микросхемы принимает минимальное значение
97. **Диапазон регулировки коэффициента усиления напряжения (тока, мощности) интегральной микросхемы** Диапазон регулировки коэффициента усиления напряжения (тока, мощности)	ΔK_{yU} ΔK_{yI} ΔK_{yP}	ΔA_U ΔA_I ΔA_P	Отношение максимального значения коэффициента усиления напряжения (тока, мощности) к минимальному значению коэффициента усиления напряжения (тока, мощности) при воздействии на интегральную микросхему управляющего электрического сигнала

Продолжение табл. 1

Термин	Буквенное обозначение		Определение
	отечественное	международное	
98. **Динамический диапазон по напряжению интегральной микросхемы** Динамический диапазон по напряжению	$\Delta U_{дин}$	ΔU_{dyn}	Отношение максимального значения выходного напряжения интегральной микросхемы к минимальному значению выходного напряжения
99. **Коэффициент нелинейности амплитудной характеристики интегральной микросхемы** Коэффициент нелинейности амплитудной характеристики	$K_{нл.А}$	A_{nla}	Наибольшее отклонение значения крутизны амплитудной характеристики интегральной микросхемы относительно значения крутизны амплитудной характеристики, изменяющейся по линейному закону
100. **Коэффициент неравномерности амплитудно-частотной характеристики интегральной микросхемы** Коэффициент неравномерности АЧХ	$K_{пр.АЧ}$	A_{PM}	Отношение максимального значения выходного напряжения интегральной микросхемы к минимальному значению в заданном диапазоне частот полосы пропускания, выраженное в децибеллах
101. **Коэффициент шума интегральной микросхемы** Коэффициент шума	$K_ш$	F_n	Отношение среднего квадратического напряжения шумов на выходе интегральной микросхемы к среднему квадратическому напряжению шума источника входного сигнала в заданной полосе частот
102. **Коэффициент интермодуляционных искажений интегральной микросхемы** Коэффициент интермодуляционных искажений	$K_{и.м}$	a_d	Отношение средней квадратической амплитуды колебаний боковых частот к амплитуде высокочастотного колебания на выходе интегральной микросхемы, выраженное в процентах
103. **Коэффициент полезного действия интегральной микросхемы** Коэффициент полезного действия	η	η	Отношение выходной мощности интегральной микросхемы к потребляемой мощности
104. **Крутизна проходной характеристики интегральной микросхемы** Крутизна проходной характеристики	$S_п$	S_{TR}	Отношение выходного тока к вызвавшему его входному напряжению в заданном электрическом режиме интегральной микросхемы

Продолжение табл. 1

Термин	Буквенное обозначение: отечественное	Буквенное обозначение: международное	Определение
105 **Отношение сигнал/шум интегральной микросхемы** Отношение сигнал/шум	$N_{с/ш}$	$N_п$	Отношение эффективного значения выходного напряжения интегральной микросхемы, содержащего только низкочастотные составляющие, соответствующие частотам модулирующего напряжения, к эффективному значению выходного напряжения при немодулированном сигнале в определенной полосе частот
106 **Фазовый сдвиг интегральной микросхемы** Фазовый сдвиг Или *Сдвиг фаз*	$\varphi_с$	$\varphi_о$	Разность между фазами выходного и входного сигналов интегральной микросхемы на заданной частоте

ПАРАМЕТРЫ, ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ НЕПРЕРЫВНЫХ СТАБИЛИЗАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ И ТОКА

107 **Диапазон выходных напряжений интегральной микросхемы** Диапазон выходных напряжений E. Output voltage operating range F. Domaine de fonctionnement de la tension de sortie	$\Delta U_{вых}$	$U_{опр}$	Интервал значений выходного напряжения интегральной микросхемы от минимального значения до максимального, при котором электрические параметры не выходят за установленные нормы
108. **Напряжение считывания обратной связи интегральной микросхемы** Напряжение считывания обратной связи E. Feedback sense voltage F. Tension de lecture de contre-réaction	—	$U_{ОБ}$	Напряжение, являющееся функцией выходного напряжения и используемое с внешними элементами или без них для управления обратной связью интегральной микросхемы
109. **Опорное напряжение интегральной микросхемы** Опорное напряжение E. Reference voltage F. Tension de référence	$U_{оп}$	U_{REF}	Напряжение, с которым сравнивается напряжение считывания обратной связи в целях контроля за интегральной микросхемой

Продолжение табл. 1

Термин	Буквенное обозначение: отечественное	Буквенное обозначение: международное	Определение
110. **Падение напряжения на интегральной микросхеме** Падение напряжения	$U_{пд}$	—	Разность между входным и выходным напряжением интегральной микросхемы в заданном режиме
111. **Минимальное падение напряжения на интегральной микросхеме** Минимальное падение напряжения	$U_{пд\ min}$	—	Наименьшее значение падения напряжения на интегральной микросхеме, при котором параметр интегральной микросхемы удовлетворяет заданным требованиям
112 Ток холостого хода интегральной микросхемы Ток холостого хода	I_{xx}	I_Q	Ток потребления интегральной микросхемы при отсутствии нагрузки на выходе
113 **Время готовности интегральной микросхемы** Время готовности	$t_{гот}$	t_{st}	Интервал времени от момента подачи входного напряжения до момента, после которого параметры интегральной микросхемы удовлетворяют заданным требованиям
114 **Время восстановления по напряжению интегральной микросхемы** Время восстановления по напряжению E. Input transient voltage recovery time F. Temps de recouvrement de la tension transitoire à l'entrée	$t_{вос\ U}$	t_{RU}	Интервал времени от момента ступенчатого изменения входного напряжения интегральной микросхемы до момента, когда значение выходного напряжения в последний раз входит в заданный интервал выходных напряжений, содержащий в себе конечное значение
115. **Время восстановления по току интегральной микросхемы** Время восстановления по току E. Input transient current recovery time F. Temps de recouvrement du courant transitoire à l'entrée	$t_{вос\ I}$	t_{RI}	Интервал времени от момента ступенчатого изменения выходного тока интегральной микросхемы до момента, когда значение выходного напряжения в последний раз входит в заданный интервал выходных напряжений, содержащих в себе конечное значение
116. **Взаимная нестабильность по напряжению интегральной микросхемы**	$K_{U\,NIN2}$	$K_{U\,NIN2}$	Относительное изменение значения выходного напряжения одного канала многоканальной интегральной

Продолжение табл. 1

Термин	Буквенное обозначение		Определение
	отечественное	международное	
Взаимная нестабильность по напряжению			микросхемы при изменении входного или выходного напряжения на другом канале, приведенное к 1 В изменения входного напряжения, при отсутствии других дестабилизирующих факторов
117. **Взаимная нестабильность по току интегральной микросхемы** Взаимная нестабильность по току	K_{IN1N2}	K_{IN1N2}	Относительное изменение значения выходного напряжения одного канала многоканальной интегральной микросхемы при изменении выходного тока на другом канале, приведенное к 1 А изменения выходного тока, при отсутствии других дестабилизирующих факторов
118. **Нестабильность по напряжению интегральной микросхемы** Нестабильность по напряжению	K_U K_U^1	K_{U1}	Относительное изменение значения выходного напряжения или тока интегральной микросхемы при изменении входного напряжения, приведенное к 1 В изменения входного напряжения, при отсутствии других дестабилизирующих факторов
119. **Нестабильность по току интегральной микросхемы** Нестабильность по току	K_I	K_{IO}	Относительное изменение значения выходного напряжения интегральной микросхемы при изменении выходного тока, приведенное к 1 А изменения выходного тока, при отсутствии других дестабилизирующих факторов
120. **Нестабильность по нагрузке интегральной микросхемы** Нестабильность по нагрузке	K_R	—	Относительное изменение значения выходного тока интегральной микросхемы при изменении сопротивления нагрузки, приведенное к 1 Ом изменения сопротивления нагрузки, при отсутствии других дестабилизирующих факторов

Продолжение табл. 1

Термин	Буквенное обозначение		Определение
	отечественное	международное	
121. Коэффициент стабилизации входного напряжения интегральной микросхемы Коэффициент стабилизации входного напряжения E. Input stabilization coefficient F. Coefficient de stabilisation en fonction de la tension d'entrée	$K_{ст\,U_{вх}}$ $K^{I}_{ст U_{вх}}$	K_{SI}	Отношение относительного изменения выходного напряжения или тока интегральной микросхемы к заданному относительному изменению входного напряжения при отсутствии других дестабилизирующих факторов
122. Коэффициент стабилизации нагрузки интегральной микросхемы Коэффициент стабилизации нагрузки E. Load stabilization coefficient F. Coefficient de stabilisation en fonction de la charge	$K_{ст\,н}$	K_{SO}	Отношение относительного изменения выходного напряжения интегральной микросхемы к заданному относительному изменению выходного тока при отсутствии других дестабилизирующих факторов
123. Коэффициент сглаживания пульсаций интегральной микросхемы Коэффициент сглаживания пульсаций E. Ripple rejection ratio F. Taux de réjection de l'ondulation résiduelle	$K_{сг}$	K_{RR}	Отношение амплитудного значения пульсаций входного напряжения заданной частоты интегральной микросхемы к амплитудному значению пульсаций выходного напряжения той же частоты
124. Дрейф выходного напряжения интегральной микросхемы Дрейф выходного напряжения E. Output voltage drift F. Dérive de la tension de sortie	$\Delta U_{вых}$	$\Delta U_{O(t)}$	Наибольшее значение относительного изменения выходного напряжения интегральной микросхемы в течение заданного интервала времени при отсутствии других дестабилизирующих факторов
125. Дрейф выходного тока интегральной микросхемы Дрейф выходного тока E. Output current drift F. Dérive du courant de sortie	$\Delta I_{вых\,t}$	$\Delta I_{O(t)}$	Наибольшее значение относительного изменения выходного тока интегральной микросхемы в течение заданного интервала времени при отсутствии других дестабилизирующих факторов

Продолжение табл. 1

Термин	Буквенное обозначение: отечественное	Буквенное обозначение: международное	Определение
126. **Температурный коэффициент выходного тока интегральной микросхемы** Температурный коэффициент выходного тока	$\alpha_{I\,вых}$	α_{IO}	Отношение относительного изменения выходного тока к вызвавшему его абсолютному изменению температуры окружающей среды или корпуса при отсутствии других дестабилизирующих факторов

ПАРАМЕТРЫ, ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ УПРАВЛЕНИЯ ИМПУЛЬСНЫМИ СТАБИЛИЗАТОРАМИ НАПРЯЖЕНИЯ

127. **Напряжение гистерезиса интегральной микросхемы** Напряжение гистерезиса	$U_{гист}$	U_h	Разность между напряжением срабатывания и напряжением отпускания интегральной микросхемы
128. **Напряжение синхронизации интегральной микросхемы** Напряжение синхронизации	$U_{сх}$	—	Напряжение, подаваемое на синхронизирующий вход интегральной микросхемы, при котором рабочая частота интегральной микросхемы равна или кратна частоте напряжения синхронизации
129. **Полоса захвата синхронизации интегральной микросхемы** Полоса захвата синхронизации	$\Delta f_{сх}$	—	Максимальное относительное отклонение собственной частоты коммутации от частоты синхронизирующего сигнала, при котором обеспечивается работа интегральной микросхемы на частоте синхронизирующего сигнала
130. **Коммутируемая мощность интегральной микросхемы** Коммутируемая мощность	$P_{ком}$	—	Значение мощности, определяемое как произведение коммутируемого напряжения на среднее квадратическое значение коммутируемого тока, в заданном режиме интегральной микросхемы
131. **Коэффициент передачи интегральной микросхемы** Коэффициент передачи	$K_{уР}$	—	Отношение абсолютного значения изменения выходного напряжения усилителя рассогласования интегральной микросхемы к абсолютному изменению входного напряжения

Продолжение табл. 1

Термин	Буквенное обозначение		Определение
	отечественное	международное	
ПАРАМЕТРЫ, ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ КОММУТАТОРОВ И КЛЮЧЕЙ			
132. **Управляющее напряжение низкого уровня интегральной микросхемы** Управляющее напряжение низкого уровня	$U_{упр.н}$	U_{IL}	Максимальное абсолютное значение напряжения на управляющем входе, обеспечивающее разомкнутое состояние ключа интегральной микросхемы
133. **Управляющее напряжение высокого уровня интегральной микросхемы** Управляющее напряжение высокого уровня	$U_{упр.в}$	U_{IH}	Минимальное абсолютное значение напряжения на управляющем входе, обеспечивающее замкнутое состояние ключа интегральной микросхемы
134. **Ток утечки аналогового входа интегральной микросхемы** Ток утечки аналогового входа	$I_{ут.вх}$	I_{LS}	Постоянный ток, протекающий через аналоговый вход (входы) интегральной микросхемы при закрытом канале (каналах)
135. **Ток утечки аналогового выхода интегральной микросхемы** Ток утечки аналогового выхода	$I_{ут.вых}$	I_{LD}	Постоянный ток, протекающий через аналоговый выход (выходы) интегральной микросхемы при закрытом канале (каналах)
136. **Входной ток низкого уровня управляющего напряжения интегральной микросхемы** Входной ток низкого уровня управляющего напряжения	$I_{вх.н}$	I_{IL}	Постоянный ток, протекающий через управляющий вход (входы) интегральной микросхемы при подаче на него (них) управляющего напряжения низкого уровня
137. **Входной ток высокого уровня управляющего напряжения интегральной микросхемы** Входной ток высокого уровня управляющего напряжения	$I_{вх.в}$	I_{IH}	Постоянный ток, протекающий через управляющий вход (входы) интегральной микросхемы при подаче на него (них) управляющего напряжения высокого уровня
138. **Ток потребления при низком уровне управляющего напряжения интегральной микросхемы** Ток потребления при низком уровне управляющего напряжения	$I_{пот.н}$	I_{CCL}	Постоянный ток, протекающий через вывод (выводы) питания интегральной микросхемы при подаче на управляющий вход (входы) управляющего напряжения низкого уровня

Продолжение табл. 1

Термин	Буквенное обозначение		Определение
	отечественное	международное	
139. **Ток потребления при высоком уровне управляющего напряжения интегральной микросхемы** Ток потребления при высоком уровне управляющего напряжения	$I_{пот.в}$	I_{CCH}	Постоянный ток, протекающий через вывод (выводы) питания интегральной микросхемы, при подаче на управляющий вход (входы) управляющего напряжения высокого уровня
140. **Сопротивление в открытом состоянии интегральной микросхемы** Сопротивление в открытом состоянии	$R_{отк}$	R_{ON}	Отношение падения напряжения между аналоговым выходом и аналоговым входом интегральной микросхемы к вызвавшему его току при включенном канале
141. **Время включения интегральной микросхемы** Время включения	$t_{вкл}$	t_{on}	Интервал времени между уровнем 0,5 управляющего напряжения интегральной микросхемы и заданным уровнем выходного напряжения в режиме включения
142. **Время выключения интегральной микросхемы** Время выключения	$t_{выкл}$	t_{off}	Интервал времени между уровнем 0,5 управляющего напряжения интегральной микросхемы и заданным уровнем выходного напряжения в режиме выключения
143. **Время переключения интегральной микросхемы** Время переключения	$t_{пер}$	t_{trans}	Интервал времени между уровнем 0,5 управляющего напряжения интегральной микросхемы и заданным уровнем выходного напряжения в режиме параллельного переключения
144. **Амплитуда выбросов напряжения на аналоговом выходе интегральной микросхемы** Амплитуда выбросов напряжения на аналоговом выходе	$U_{оп.а}$	U_{DA}	Максимальная амплитуда выбросов напряжения на аналоговом выходе интегральной микросхемы, работающей в режиме переключения при отсутствии коммутируемого напряжения
145. **Емкость управляющего входа интегральной микросхемы** Емкость управляющего входа	$C_{вх.упр}$	C_I	Отношение емкостной реактивной составляющей тока, протекающего через управляющий вход, интегральной микросхемы, к произведению синусоидального напряжения, вызвавшего

Продолжение табл. 1

Термин	Буквенное обозначение		Определение
	отечественное	международное	
			этот ток, и его круговой частоты при закрытом канале (каналах)
146. **Емкость аналогового входа интегральной микросхемы** Емкость аналогового входа	$C_{вх.ан}$	C_S	Отношение емкостной реактивной составляющей тока, протекающего через аналоговый вход интегральной микросхемы, к произведению синусоидального напряжения, вызвавшего этот ток, и его круговой частоты при закрытом канале (каналах)
147. **Емкость аналогового выхода интегральной микросхемы** Емкость аналогового выхода	$C_{вых.ан}$	C_D	Отношение емкостной реактивной составляющей тока, протекающего через аналоговый выход интегральной микросхемы, к произведению синусоидального напряжения, вызвавшего этот ток, и его круговой частоты при закрытом канале (каналах)
148. **Емкость между аналоговыми выходом и входом интегральной микросхемы** Емкость между аналоговыми выходом и входом	$C_{вых/вх.ан}$	C_{DS}	Отношение емкостной реактивной составляющей тока, протекающего между аналоговым выходом и аналоговым входом интегральной микросхемы, к произведению синусоидального напряжения, вызвавшего этот ток, и его круговой частоты при закрытом канале (каналах)
149. **Частота управляющего напряжения интегральной микросхемы** Частота управляющего напряжения	$f_{упр}$	f_I	Частота напряжения на управляющем входе интегральной микросхемы при заданной скважности, при которой значения выходного напряжения низкого и высокого уровней удовлетворяют заданным значениям
150. **Коэффициент подавления сигнала разомкнутым ключом интегральной микросхемы** Коэффициент подавления сигнала разомкнутым ключом	$K_{под.и}$	K_{Doff}	Отношение переменной составляющей выходного напряжения закрытого канала интегральной микросхемы к переменной составляющей коммутируемого напряжения

Продолжение табл. 1

Термин	Буквенное обозначение: отечественное	Буквенное обозначение: международное	Определение
151. **Коэффициент подавления сигнала между каналами интегральной микросхемы** Коэффициент подавления сигнала между каналами	$K_{\text{под}}$	K_{Don}	Отношение переменной составляющей коммутируемого напряжения открытого канала интегральной микросхемы к переменной составляющей выходного напряжения на любом другом закрытом канале при отсутствии на нем коммутируемого напряжения
152. **Коэффициент передачи по напряжению интегральной микросхемы** Коэффициент передачи по напряжению	$K_{\text{п}}$	K_U	Отношение напряжения на выходе интегральной микросхемы к заданному значению коммутируемого напряжения при включенном канале

ПАРАМЕТРЫ, ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ ЦИФРОВЫХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ

153. **Напряжение i-го источника питания интегральной микросхемы** Напряжение i-го источника питания	$U_{\text{пi}}$	U_{CCi}	Напряжение i-го источника питания, обеспечивающего работу интегральной микросхемы в заданном режиме. Примечание. i — порядковый номер источника. i=1—4
154. **Входное напряжение низкого уровня интегральной микросхемы** Входное напряжение низкого уровня	$U^0_{\text{вх}}$	U_{IL}	Напряжение низкого уровня на входе интегральной микросхемы. Примечание. Напряжение низкого уровня — наименее положительное (наиболее отрицательное) напряжение
155. **Входное напряжение высокого уровня интегральной микросхемы** Входное напряжение высокого уровня	$U^1_{\text{вх}}$	U_{IH}	Напряжение высокого уровня на выходе интегральной микросхемы. Примечание. Напряжение высокого уровня — наиболее положительное (наименее отрицательное) напряжение

Продолжение табл. 1

Термин	Буквенное обозначение		Определение
	отечественное	международное	
156. **Прямое падение напряжения на антизвонном диоде интегральной микросхемы** Прямое падение напряжения на антизвонном диоде	$U_{пр}$	U_{CD1}	Напряжение на входе интегральной микросхемы при заданном значении входного тока через защитный диод
157. **Выходное напряжение высокого уровня интегральной микросхемы** Выходное напряжение высокого уровня	$U^1_{вых}$	U_{OH}	—
158. **Выходное напряжение низкого уровня интегральной микросхемы** Выходное напряжение низкого уровня	$U^0_{вых}$	U_{OL}	—
159. **Ток потребления *i*-го источника питания интегральной микросхемы** Ток потребления *i*-го источника питания	$I_{пот\,i}$	I_{CCi}	Ток, потребляемый интегральной микросхемой от *i*-го источника питания в заданном режиме
160. **Динамический ток потребления интегральной микросхемы** Динамический ток потребления	$I_{пот.дин}$	I_{CCC}	Ток потребления интегральной микросхемы в режиме переключения
161. **Входной ток низкого уровня интегральной микросхемы** Входной ток низкого уровня	$I^0_{вх}$	I_{IL}	Входной ток при входном напряжении низкого уровня интегральной микросхемы
162. **Входной ток высокого уровня интегральной микросхемы** Входной ток высокого уровня	$I^1_{вх}$	I_{IH}	Входной ток при входном напряжении высокого уровня интегральной микросхемы
163. **Выходной ток высокого уровня интегральной микросхемы** Выходной ток высокого уровня	$I^1_{вых}$	I_{OH}	Выходной ток при выходном напряжении высокого уровня интегральной микросхемы
164. **Выходной ток низкого уровня интегральной микросхемы** Выходной ток низкого уровня	$I^0_{вых}$	I_{OL}	Выходной ток при выходном напряжении низкого уровня интегральной микросхемы

Продолжение табл. 1

Термин	Буквенное обозначение		Определение
	отечественное	международное	
165. **Выходной ток в состоянии «Выключено» интегральной микросхемы** Выходной ток в состоянии «Выключено»	$I_{\text{вых.выкл}}$	I_{O2}	Выходной ток интегральной микросхемы с тремя состояниями на выходе при выключенном состоянии выхода
166. **Выходной ток низкого уровня в состоянии «Выключено» интегральной микросхемы** Выходной ток низкого уровня в состоянии «Выключено»	$I^0_{\text{вых.выкл}}$	I_{OZL}	Выходной ток в состоянии «Выключено» интегральной микросхемы при подаче на измеряемый выход заданного напряжения низкого уровня
167. **Выходной ток высокого уровня в состоянии «Выключено» интегральной микросхемы** Выходной ток высокого уровня в состоянии «Выключено»	$I^1_{\text{вых.выкл}}$	I_{OZH}	Выходной ток в состоянии «Выключено» интегральной микросхемы при подаче на измеряемый выход заданного напряжения высокого уровня
168. **Ток утечки на входе интегральной микросхемы** Ток утечки на входе	$I_{\text{ут.вх}}$	I_{IL}	Ток во входной цепи интегральной микросхемы при закрытом состоянии входа и заданных режимах на остальных выводах
169. **Ток утечки на выходе интегральной микросхемы** Ток утечки на выходе	$I_{\text{ут.вых}}$	I_{OL}	Ток в выходной цепи интегральной микросхемы при закрытом состоянии выхода и заданных режимах на остальных выводах
170. **Ток утечки низкого уровня на входе интегральной микросхемы** Ток утечки низкого уровня на входе	$I^0_{\text{ут.вх}}$	I_{ILL}	Ток утечки во входной цепи интегральной микросхемы при входных напряжениях в диапазоне, соответствующем низкому уровню, и при заданных режимах на остальных выводах
171. **Ток утечки высокого уровня на входе интегральной микросхемы** Ток утечки высокого уровня на входе	$I^1_{\text{ут.вх}}$	I_{ILH}	Ток утечки во входной цепи интегральной микросхемы при входных напряжениях в диапазоне, соответствующем высокому уровню, и при заданных режимах на остальных выводах

Продолжение табл. 1

Термин	Буквенное обозначение		Определение
	отечественное	международное	
172. **Ток утечки низкого уровня на выходе интегральной микросхемы** Ток утечки низкого уровня на выходе	$I^0_{\text{ут.вых}}$	I_{OLL}	Ток утечки интегральной микросхемы при закрытом состоянии выхода при напряжении на выходе в диапазоне, соответствующем низкому уровню, и при заданных режимах на остальных выводах
173. **Ток утечки высокого уровня на выходе интегральной микросхемы** Ток утечки высокого уровня на выходе	$I^1_{\text{ут.вых}}$	I_{OLH}	Ток утечки интегральной микросхемы при закрытом состоянии выхода, при напряжении на выходе в диапазоне, соответствующем высокому уровню, и при заданных режимах на остальных выводах
174. **Потребляемая мощность i-го источника питания интегральной микросхемы** Потребляемая мощность i-го источника питания	$P_{\text{пот}i}$	P_{CCi}	Мощность, потребляемая интегральной микросхемой в заданном режиме, от i-го источника питания
175. **Время перехода при включении интегральной микросхемы** Время перехода при включении	$t^{1,0}$	t_{THL}	Интервал времени, в течение которого напряжение на выходе интегральной микросхемы переходит от напряжения высокого уровня к напряжению низкого уровня, измеренный на уровнях 0,1 и 0,9 или на заданных значениях напряжения
176. **Время перехода при выключении интегральной микросхемы** Время перехода при выключении	$t^{0,1}$	t_{TLH}	Интервал времени, в течение которого напряжение на выходе интегральной микросхемы переходит от напряжения низкого уровня к напряжению высокого уровня, измеренный на уровнях 0,1 и 0,9 или на заданных значениях напряжения
177. **Время выбора интегральной микросхемы** Время выбора	$t_в$	t_{CS}	Интервал времени между подачей на вход сигнала выбора интегральной микросхемы и получением на выходе сигналов информации

Продолжение табл. 1

Термин	Буквенное обозначение		Определение
	отечественное	международное	
178. **Время сохранения сигнала интегральной микросхемы** Время сохранения E. Valid time F. Temps de validation	$t_{сх}$	t_V	Интервал времени, в течение которого выходной сигнал является достоверным или в течение которого входной сигнал должен оставаться достоверным
179. **Время хранения информации интегральной микросхемы** Время хранения информации	$t_{хр}$	t_{SO}	Интервал времени, в течение которого интегральная микросхема в заданном режиме эксплуатации сохраняет информацию
180. **Время установления входных сигналов интегральной микросхемы** Время установления входных сигналов F. Set-up time F. Temps de préparation	$t_{уст}$	t_{SU}	Интервал времени между началом сигнала на заданном выводе входа и последующим активным переходом на другом заданном выводе входа
181. **Время цикла интегральной микросхемы** Время цикла E. Cycle time F. Temps de cycle	$t_ц$	t_{CY}	Длительность периода сигналов на одном из управляющих входов, в течение которой интегральная микросхема выполняет одну из функций
182. **Время восстановления интегральной микросхемы** Время восстановления	$t_{вос}$	t_{REC}	Интервал времени между окончанием заданного сигнала на выводе интегральной микросхемы и началом заданного сигнала следующего цикла
183. **Время задержки распространения при включении интегральной микросхемы** Время задержки распространения при включении	$t^{1,0}_{зд.р}$	t_{PHL}	Интервал времени между входным и выходным импульсами при переходе напряжения на выходе интегральной микросхемы от напряжения высокого уровня к напряжению низкого уровня, измеренный на уровне 0,5 или на заданных значениях напряжения
184. **Время задержки распространения при выключении интегральной микросхемы** Время задержки распространения при выключении	$t^{0,1}_{зд.р}$	t_{PLH}	Интервал времени между входным и выходным импульсами при переходе напряжения на выходе интегральной микросхемы от напряжения низкого уровня к напряжению высокого

Продолжение табл. 1

Термин	Буквенное обозначение		Определение
	отечественное	международное	
			уровня, измеренный на уровне 0,5 или на заданных значениях напряжения
185. **Время задержки включения интегральной микросхемы** Время задержки включения	$t_{зд}^{1,0}$	t_{DHL}	Интервал времени между входным и выходным импульсами при переходе напряжения на выходе интегральной микросхемы от напряжения высокого уровня к напряжению низкого уровня, измеренный на уровне 0,1 или на заданных значениях напряжения
186. **Время задержки выключения интегральной микросхемы** Время задержки выключения	$t_{зд}^{0,1}$	t_{DLH}	Интервал времени между входным и выходным импульсами при переходе напряжения на выходе интегральной микросхемы от напряжения низкого уровня к напряжению высокого уровня, измеренный на уровне 0,9 или на заданных значениях напряжения
187. **Длительность сигнала интегральной микросхемы** Длительность сигнала	τ	t_W	Интервал времени между заданными контрольными точками по фронтам импульса интегральной микросхемы
188. **Длительность сигнала низкого уровня интегральной микросхемы** Длительность сигнала низкого уровня	τ^0	t_{WL}	Интервал времени от момента перехода сигнала интегральной микросхемы из состояния высокого уровня в состояние низкого уровня до момента его перехода из состояния низкого уровня в состояние высокого уровня, измеренный на заданном уровне напряжения
189. **Длительность сигнала высокого уровня интегральной микросхемы** Длительность сигнала высокого уровня	τ^1	t_{WH}	Интервал времени от момента перехода сигнала интегральной микросхемы из состояния низкого уровня в состояние высокого уровня до момента перехода его из состояния высокого уровня в состояние низкого уровня, измеренный на заданном уровне напряжения

Продолжение табл. 1

Термин	Буквенное обозначение: отечественное	Буквенное обозначение: международное	Определение
190. **Частота следования импульсов тактовых сигналов интегральной микросхемы** Частота следования импульсов тактовых сигналов	$f_т$	f_C	—
191. **Период следования импульсов тактовых сигналов интегральной микросхемы** Период следования импульсов тактовых сигналов	$T_т$	T_C	Интервал времени между началами или окончаниями следующих друг за другом импульсов тактовых сигналов интегральной микросхемы, измеренный на заданном уровне напряжения
192. **Помехоустойчивость при низком уровне сигнала интегральной микросхемы** Помехоустойчивость при низком уровне сигнала	$U^0_{пом}$	M_L	Абсолютное значение разности между максимальным входным напряжением низкого уровня и максимальным выходным напряжением низкого уровня интегральной микросхемы
193. **Помехоустойчивость при высоком уровне сигнала интегральной микросхемы** Помехоустойчивость при высоком уровне сигнала	$U^1_{пом}$	M_H	Абсолютное значение разности между минимальным входным напряжением высокого уровня и минимальным выходным напряжением высокого уровня интегральной микросхемы
194. **Емкость входа/выхода интегральной микросхемы** Емкость входа/выхода	$C_{вх/вых}$	$C_{I/O}$	Значение емкости объединенного входа/выхода, равное отношению емкостной реактивной составляющей входного или выходного тока интегральной микросхемы к произведению круговой частоты на синусоидальное входное или выходное напряжение при заданном значении частоты сигнала

ПАРАМЕТРЫ, ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ ЭЛЕМЕНТОВ ЛОГИЧЕСКИХ И СХЕМ ЦИФРОВЫХ УСТРОЙСТВ

195. **Выходное пороговое напряжение высокого уровня интегральной микросхемы**	$U^1_{пор.вых}$	$U_{отн}$	Наименьшее значение напряжения высокого уровня на выходе интегральной микросхемы при пороговом напряжении на входе

Продолжение табл. 1

Термин	Буквенное обозначение: отечественное	Буквенное обозначение: международное	Определение
Выходное пороговое напряжение высокого уровня			
196. **Выходное пороговое напряжение низкого уровня интегральной микросхемы** Выходное пороговое напряжение низкого уровня	$U^0_{\text{пор.вых}}$	U_{OTL}	Наибольшее значение напряжения низкого уровня на выходе интегральной микросхемы при пороговом напряжении на входе
197. **Входное пороговое напряжение высокого уровня интегральной микросхемы** Входное пороговое напряжение высокого уровня	$U^1_{\text{пор.вх}}$	U_{ITH}	Наименьшее значение напряжения высокого уровня на входе интегральной микросхемы, при котором происходит переход интегральной микросхемы из одного устойчивого состояния в другое
198. **Входное пороговое напряжение низкого уровня интегральной микросхемы** Входное пороговое напряжение низкого уровня	$U^0_{\text{пор.вх}}$	U_{ITL}	Наибольшее значение напряжения низкого уровня на входе интегральной микросхемы, при котором происходит переход интегральной микросхемы из одного устойчивого состояния в другое
199. **Входное напряжение блокировки интегральной микросхемы** Входное напряжение блокировки	$U_{\text{вх.бл}}$	U_{IK}	Наименьшее значение напряжения на входе интегральной микросхемы при заданном значении входного тока
200. **Входной пробивной ток интегральной микросхемы** Входной пробивной ток	$I_{\text{вх.проб}}$	I_{IB}	Входной ток при максимальном напряжении на входе интегральной микросхемы, не вызывающем необратимых процессов в микросхеме
201. **Ток потребления выходного напряжения низкого уровня интегральной микросхемы** Ток потребления выходного напряжения низкого уровня	$I^0_{\text{пот}}$	I_{CCL}	Ток, потребляемый интегральной микросхемой от источника питания, при выходном напряжении низкого уровня

Продолжение табл. 1

Термин	Буквенное обозначение: отечественное	Буквенное обозначение: международное	Определение
202. **Ток потребления выходного напряжения высокого уровня интегральной микросхемы** Ток потребления выходного напряжения высокого уровня	$I_{\text{пот}}^{1}$	I_{CCH}	Ток, потребляемый интегральной микросхемой от источника питания, при выходном напряжении высокого уровня
203. **Средний ток потребления интегральной микросхемы** Средний ток потребления	$I_{\text{пот.ср}}$	I_{CCAV}	Ток, равный полусумме токов, потребляемых интегральной микросхемой от источников питания в двух различных устойчивых состояниях
204. **Средняя потребляемая мощность интегральной микросхемы** Средняя потребляемая мощность	$P_{\text{пот.ср}}$	P_{CCAV}	Мощность, равная полусумме мощностей, потребляемых интегральной микросхемой от источников питания в двух различных устойчивых состояниях
205. **Среднее время задержки распространения интегральной микросхемы** Среднее время задержки распространения	$t_{\text{зд.р.ср}}$	t_{PAV}	Интервал времени, равный полусумме времен задержки распространения сигнала при включении и выключении интегральной микросхемы
206. **Время задержки распространения при переходе из состояния высокого уровня в состояние «Выключено»**	$t_{\text{зд.р}}^{1,3}$	t_{PHZ}	Интервал времени между входным и выходным импульсами при переходе напряжения на выходе интегральной микросхемы от напряжения высокого уровня к напряжению в состоянии «Выключено»
207. **Время задержки распространения при переходе из состояния низкого уровня в состояние «Выключено»**	$t_{\text{зд.р}}^{0,3}$	t_{PLZ}	Интервал времени между входным и выходным импульсами при переходе напряжения на выходе интегральной микросхемы от напряжения низкого уровня к напряжению в состоянии «Выключено»
208. **Время задержки распространения при переходе из состояния «Выключено» в состояние высокого уровня**	$t_{\text{зд.р}}^{3,1}$	t_{PZH}	Интервал времени между входным и выходным импульсами при переходе напряжения на выходе интегральной микросхемы от напряжения в состоянии «Выключено» к напряжению высокого уровня

Продолжение табл. 1

Термин	Буквенное обозначение		Определение
	отечественное	международное	
209. Время задержки распространения при переходе из состояния «Выключено» в состояние низкого уровня	$t^{3,0}_{\text{зд.р}}$	t_{PZL}	Интервал времени между входным и выходным импульсами при переходе напряжения на выходе интегральной микросхемы от напряжения в состоянии «Выключено» к напряжению низкого уровня
210. Рабочая частота интегральной микросхемы Рабочая частота	f	f	Частота сигнала, подаваемого на вход интегральной микросхемы при заданных скважности и условиях на других входах, при которой на выходе обеспечиваются заданные уровни напряжений
211. Коэффициент разветвления по выходу интегральной микросхемы Коэффициент разветвления по выходу	$K_{\text{раз}}$	N	Число единичных нагрузок, которое можно одновременно подключить к выходу интегральной микросхемы. Примечание. Единичной нагрузкой является один вход основного логического элемента данной серии интегральных микросхем
212. Коэффициент объединения по входу интегральной микросхемы Коэффициент объединения по входу	$K_{\text{об}}$	N_I	Число входов интегральной микросхемы, по которым реализуется логическая функция

ПАРАМЕТРЫ, ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ

213. Напряжение инжектора при заданном токе инжектора интегральной микросхемы Напряжение инжектора при заданном токе инжектора	$U_{\text{инж}}$	U_G	—

Продолжение табл. 1

Термин	Буквенное обозначение: отечественное	Буквенное обозначение: международное	Определение
214. **Максимальное входное напряжение низкого уровня интегральной микросхемы** Максимальное входное напряжение низкого уровня	$U^0_{\text{вх max}}$	U_{ILmax}	Наибольшее положительное или наименьшее отрицательное значение напряжения из допустимого диапазона входных напряжений низкого уровня интегральной микросхемы
215. **Максимальное входное напряжение высокого уровня интегральной микросхемы** Максимальное входное напряжение высокого уровня	$U^1_{\text{вх max}}$	U_{IHmax}	Наибольшее положительное или наименьшее отрицательное значение напряжения из допустимого диапазона входных напряжений высокого уровня интегральной микросхемы
216. **Минимальное входное напряжение низкого уровня интегральной микросхемы** Минимальное входное напряжение низкого уровня	$U^0_{\text{вх min}}$	U_{ILmin}	Наименьшее положительное или наибольшее отрицательное значение напряжения из допустимого диапазона входных напряжений низкого уровня интегральной микросхемы
217. **Минимальное входное напряжение высокого уровня интегральной микросхемы** Минимальное входное напряжение высокого уровня	$U^1_{\text{вх min}}$	U_{IHmin}	Наименьшее положительное или наибольшее отрицательное значение напряжения из допустимого диапазона входных напряжений высокого уровня интегральной микросхемы
218. **Максимальное выходное напряжение низкого уровня интегральной микросхемы** Максимальное выходное напряжение низкого уровня	$U^0_{\text{вых max}}$	U_{OLmax}	Наибольшее положительное или наименьшее отрицательное значение напряжения из допустимого диапазона выходных напряжений низкого уровня интегральной микросхемы
219. **Минимальное выходное напряжение высокого уровня интегральной микросхемы** Минимальное выходное напряжение высокого уровня	$U^1_{\text{вых min}}$	U_{OHmin}	Наименьшее положительное или наибольшее отрицательное значение напряжения из допустимого диапазона выходных напряжений высокого уровня интегральной микросхемы
220. **Ток инжектора интегральной микросхемы** Ток инжектора	$I_{\text{инж}}$	I_G	Ток в цепи вывода питания, необходимый для работы интегральной микросхемы в заданном режиме

Продолжение табл. 1

Термин	Буквенное обозначение: отечественное	Буквенное обозначение: международное	Определение
221. **Ток потребления в состоянии «Выключено» интегральной микросхемы** Ток потребления в состоянии «Выключено»	$I_{\text{пот.выкл}}$	I_{CCZ}	Ток потребления интегральной микросхемы при закрытом состоянии выхода. Примечание. Термин используют для схем с тремя состояниями на выходе

ПАРАМЕТРЫ, ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ ЗАПОМИНАЮЩИХ УСТРОЙСТВ

222. **Напряжение питания в режиме хранения интегральной микросхемы** Напряжение питания в режиме хранения	$U_{\text{п.хр}}$	U_{CCS}	Напряжение источника питания, необходимое для хранения информации интегральной микросхемы
223. **Напряжение сигнала входной информации интегральной микросхемы** Напряжение сигнала входной информации	$U_{\text{сх.и}}$	U_{DI}	Наибольшее или наименьшее значение напряжения на входе сигнала информации, обеспечивающее ввод информации в интегральную микросхему
224. **Напряжение низкого уровня сигнала входной информации интегральной микросхемы** Напряжение низкого уровня сигнала входной информации	$U^0_{\text{вх.и}}$	U_{DIL}	Наибольшее значение напряжения низкого уровня на входе сигнала информации, обеспечивающее ввод информации в интегральную микросхему
225. **Напряжение высокого уровня сигнала входной информации интегральной микросхемы** Напряжение высокого уровня сигнала входной информации	$U^1_{\text{вх.и}}$	U_{DIH}	Наименьшее значение напряжения высокого уровня на входе сигнала информации, обеспечивающее ввод информации в интегральную микросхему
226. **Напряжение сигнала выходной информации интегральной микросхемы** Напряжение сигнала выходной информации	$U_{\text{вых.и}}$	U_{DO}	Напряжение на выходе сигнала информации интегральной микросхемы

Продолжение табл. 1

Термин	Буквенное обозначение: отечественное	Буквенное обозначение: международное	Определение
227. **Напряжение низкого уровня сигнала выходной информации интегральной микросхемы** Напряжение низкого уровня сигнала выходной информации	$U^0_{вых.и}$	U_{DOL}	Напряжение на выходе сигнала информации интегральной микросхемы, соответствующее низкому уровню
228. **Напряжение высокого уровня сигнала выходной информации интегральной микросхемы** Напряжение высокого уровня сигнала выходной информации	$U^1_{вых.и}$	U_{DOH}	Напряжение на выходе сигнала информации интегральной микросхемы, соответствующее высокому уровню
229 **Напряжение *сигнала записи* интегральной микросхемы** Напряжение сигнала записи	$U_{зп}$	U_{WH}	Наибольшее или наименьшее *значение напряжения* на входе сигнала записи, при котором выполняется запись информации в интегральную микросхему
230. **Напряжение низкого уровня сигнала записи интегральной микросхемы** Напряжение низкого уровня сигнала записи	$U^0_{зп}$	U_{WRL}	Наибольшее значение напряжения низкого уровня на входе сигнала записи, при котором выполняется запись информации в интегральную микросхему
231. **Напряжение высокого уровня *сигнала* записи интегральной микросхемы** Напряжение высокого уровня сигнала записи	$U^1_{зп}$	U_{WRH}	Наименьшее значение *напряжения высокого уровня* на входе сигнала записи, при котором выполняется операция записи информации в интегральную микросхему
232. **Напряжение сигнала считывания интегральной микросхемы** Напряжение сигнала считывания	$U_{сч}$	U_{RD}	Наибольшее или наименьшее значение напряжения на входе сигнала считывания, обеспечивающее считывание информации из интегральной микросхемы
233. **Напряжение низкого уровня сигнала считывания интегральной микросхемы** Напряжение низкого *уровня сигнала* считывания	$U^0_{сч}$	U_{RDL}	*Наибольшее значение* напряжения низкого уровня на входе сигнала считывания, обеспечивающее считывание информации из интегральной микросхемы

Продолжение табл. 1

Термин	Буквенное обозначение		Определение
	отечественное	международное	
234. **Напряжение высокого уровня сигнала считывания интегральной микросхемы** Напряжение высокого уровня сигнала считывания	$U^1_{сч}$	U_{RDH}	Наименьшее значение напряжения высокого уровня на входе сигнала считывания, обеспечивающее считывание информации из интегральной микросхемы
235. **Напряжение сигнала разрешения интегральной микросхемы** Напряжение сигнала разрешения	$U_р$	U_{CE}	Наибольшее или наименьшее значение напряжения на входе сигнала разрешения, обеспечивающее выполнение интегральной микросхемой заданной функции
236. **Напряжение низкого уровня сигнала разрешения интегральной микросхемы** Напряжение низкого уровня сигнала разрешения	$U^0_р$	U_{CEL}	Наибольшее значение напряжения низкого уровня на входе сигнала разрешения, обеспечивающее выполнение интегральной микросхемой заданной функции
237. **Напряжение высокого уровня сигнала разрешения интегральной микросхемы** Напряжение высокого уровня сигнала разрешения	$U^1_р$	U_{CEH}	Наименьшее значение напряжения высокого уровня на входе сигнала разрешения, обеспечивающее выполнение интегральной микросхемой заданной функции
238. **Напряжение сигнала адреса интегральной микросхемы** Напряжение сигнала адреса	$U_а$	U_A	Наибольшее или наименьшее значение напряжения на входе сигнала адреса, обеспечивающее обращение к определенной ячейке интегральной микросхемы
239 **Напряжение низкого уровня сигнала адреса интегральной микросхемы** Напряжение низкого уровня сигнала адреса	$U^0_а$	U_{AL}	Наибольшее значение напряжения низкого уровня на входе сигнала адреса, обеспечивающее обращение к определенной ячейке интегральной микросхемы
240. **Напряжение высокого уровня сигнала адреса интегральной микросхемы** Напряжение высокого уровня сигнала адреса	$U^1_а$	U_{AH}	Наименьшее значение напряжения высокого уровня на входе сигнала адреса, обеспечивающее обращение к определенной ячейке интегральной микросхемы

Продолжение табл. 1

Термин	Буквенное обозначение		Определение
	отечественное	международное	
241. **Напряжение сигнала запись-считывание интегральной микросхемы** Напряжение сигнала запись-считывание	$U_{зп/сч}$	$U_{WR/RD}$	Наибольшее или наименьшее значение напряжения на выводе сигнала запись-считывание интегральной микросхемы, обеспечивающее выполнение функции записи или считывания
242. **Напряжение низкого уровня сигнала запись-считывание интегральной микросхемы** Напряжение низкого уровня сигнала запись-считывание	$U^0_{зп/сч}$	$U_{WR/RDL}$	Наибольшее значение напряжения на выводе сигнала запись-считывание интегральной микросхемы, обеспечивающее выполнение функции записи или считывания
243. **Напряжение высокого уровня сигнала запись-считывание интегральной микросхемы** Напряжение высокого уровня сигнала запись-считывание	$U^1_{зп/сч}$	$U_{WR/RDH}$	Наименьшее значение напряжения высокого уровня на выводе сигнала запись-считывание интегральной микросхемы, обеспечивающее выполнение функции записи или считывания
244. **Напряжение сигнала выбора интегральной микросхемы** Напряжение сигнала выбора	$U_{в.м}$	U_{CS}	Наибольшее или наименьшее значение напряжения на входе сигнала выбора интегральной микросхемы
245. **Напряжение низкого уровня сигнала выбора интегральной микросхемы** Напряжение низкого уровня сигнала выбора	$U^0_{в.м}$	U_{CSL}	Наибольшее значение напряжения низкого уровня на входе сигнала выбора интегральной микросхемы
246. **Напряжение высокого уровня сигнала выбора интегральной микросхемы** Напряжение высокого уровня сигнала выбора	$U^1_{в.м}$	U_{CSH}	Наименьшее значение напряжения высокого уровня на входе сигнала выбора интегральной микросхемы
247. **Напряжение тактового сигнала интегральной микросхемы** Напряжение тактового сигнала	$U_т$	U_C	Наибольшее или наименьшее значение напряжения на входе тактового сигнала, обеспечивающее работу интегральной микросхемы в определенный интервал времени

Продолжение табл. 1

Термин	Буквенное обозначение		Определение
	отечественное	международное	
248. **Напряжение сигнала выбора адреса столбцов интегральной микросхемы** Напряжение сигнала выбора адреса столбцов	$U_{в.а.к}$	U_{CAS}	Напряжение на входе сигнала выбора адреса столбцов интегральной микросхемы
249. **Напряжение низкого уровня сигнала выбора адреса столбцов интегральной микросхемы** Напряжение низкого уровня сигнала выбора адреса столбцов	$U^0_{в.а.к}$	U_{CASL}	Напряжение на входе сигнала выбора адреса столбцов интегральной микросхемы, соответствующее низкому уровню
250. **Напряжение высокого уровня сигнала выбора адреса столбцов интегральной микросхемы** Напряжение высокого уровня сигнала выбора адреса столбцов	$U^1_{в.а.к}$	U_{CASH}	Напряжение на входе сигнала выбора адреса столбцов интегральной микросхемы, соответствующее высокому уровню
251. **Напряжение сигнала выбора адреса строк интегральной микросхемы** Напряжение сигнала выбора адреса строк	$U_{в.а.с}$	U_{RAS}	Напряжение на входе сигнала выбора адреса строк интегральной микросхемы
252. **Напряжение низкого уровня сигнала выбора адреса строк интегральной микросхемы** Напряжение низкого уровня сигнала выбора адреса строк	$U^0_{в.а.с}$	U_{RASL}	Напряжение на входе сигнала выбора адреса строк интегральной микросхемы, соответствующее низкому уровню
253. **Напряжение высокого уровня сигнала выбора адреса строк интегральной микросхемы** Напряжение высокого уровня сигнала выбора адреса строк	$U^1_{в.а.с}$	U_{RASH}	Напряжение на входе сигнала выбора адреса строк интегральной микросхемы, соответствующее высокому уровню
254. **Напряжение сигнала стирания интегральной микросхемы** Напряжение сигнала стирания	$U_{ст}$	U_{ERA}	Наибольшее или наименьшее значение напряжения на выводе сигнала «стирание» интегральной микросхемы, обеспечивающее стирание информации

Продолжение табл. 1

Термин	Буквенное обозначение		Определение
	отечественное	международное	
255. Напряжение сигнала программирования интегральной микросхемы Напряжение сигнала программирования	$U_{пр}$	U_{PI}	Наибольшее или наименьшее значение напряжения на выводе сигнала программирования интегральной микросхемы, обеспечивающее изменение информации в программируемых запоминающих устройствах с перепрограммированием
256. **Ток потребления в режиме хранения интегральной микросхемы** Ток потребления в режиме хранения	$I_{пот.хр}$	I_{CCS}	Ток, потребляемый интегральной микросхемой от источника или источников питания в режиме хранения информации
257. **Ток сигнала входной информации интегральной микросхемы** Ток сигнала входной информации	$I_{вх.и}$	I_{DI}	Ток в цепи сигнала входной информации интегральной микросхемы
258. **Ток низкого уровня сигнала входной информации интегральной микросхемы** Ток низкого уровня сигнала входной информации	$I^0_{вх.и}$	I_{DIL}	Ток в цепи сигнала входной информации интегральной микросхемы, соответствующий низкому уровню
259. **Ток высокого уровня сигнала входной информации интегральной микросхемы** Ток высокого уровня входной информации	$I^1_{вх.и}$	I_{DIH}	Ток в цепи сигнала входной информации интегральной микросхемы, соответствующий высокому уровню
260 **Ток сигнала выходной информации интегральной микросхемы** Ток сигнала выходной информации	$I_{вых.и}$	I_{DO}	Ток в цепи сигнала выходной информации интегральной микросхемы
261. **Ток низкого уровня сигнала выходной информации интегральной микросхемы** Ток низкого уровня сигнала выходной информации	$I^0_{вых.и}$	I_{DO}	Ток в цепи сигнала выходной информации интегральной микросхемы, соответствующий низкому уровню
262. **Ток высокого уровня сигнала выходной информации интегральной микросхемы**	$I^1_{вых.и}$	I_{DOH}	Ток в цепи сигнала выходной информации интегральной микросхемы, соответствующий высокому уровню

Продолжение табл. 1

Термин	Буквенное обозначение		Определение
	отечественное	международное	
Ток высокого уровня сигнала выходной информации			
263 **Ток сигнала записи интегральной микросхемы**	$I_{зп}$	I_{WR}	Ток в цепи сигнала записи интегральной микросхемы
Ток сигнала записи			
264. **Ток сигнала считывания интегральной микросхемы**	$I_{сч}$	I_{RD}	Ток в цепи сигнала считывания интегральной микросхемы
Ток сигнала считывания			
265. **Ток сигнала адреса интегральной микросхемы**	$I_{а}$	I_{A}	Ток в цепи сигнала адреса интегральной микросхемы
Ток сигнала адреса			
266. **Ток сигнала запись-считывание интегральной микросхемы**	$I_{зп/сч}$	$I_{WR/RD}$	Ток в цепи сигнала запись-считывание интегральной микросхемы в заданном режиме
Ток сигнала запись-считывание			
267. **Ток сигнала выбора интегральной микросхемы**	$I_{в.м}$	I_{CS}	Ток в цепи сигнала выбора интегральной микросхемы
Ток сигнала выбора			
268. **Ток низкого уровня по входу выбора интегральной микросхемы**	$I^{0}_{в.м}$	I_{CSL}	Ток в цепи сигнала выбора интегральной микросхемы, соответствующий низкому уровню
Ток низкого уровня по входу выбора			
269. **Ток высокого уровня по входу выбора интегральной микросхемы**	$I^{1}_{в.м}$	I_{CSH}	Ток в цепи сигнала выбора интегральной микросхемы, соответствующий высокому уровню
Ток высокого уровня по входу выбора			
270. **Ток сигнала разрешения интегральной микросхемы**	$I_{р}$	I_{CE}	Ток в цепи сигнала разрешения интегральной микросхемы
Ток сигнала разрешения			
271 **Ток сигнала стирания интегральной микросхемы**	$I_{стр}$	I_{ERA}	Ток в цепи сигнала стирания интегральной микросхемы
Ток сигнала стирания			
272. **Ток тактового сигнала интегральной микросхемы**	$I_{т}$	I_{C}	Ток в цепи импульсного питания интегральной микросхемы динамических запоминающих устройств
Ток тактового сигнала			

Продолжение табл. 1

Термин	Буквенное обозначение: отечественное	Буквенное обозначение: международное	Определение
273. **Ток сигнала выбора адреса столбцов интегральной микросхемы** Ток сигнала выбора адреса столбцов	$I_{в.а.к}$	I_{CAS}	Ток в цепи сигнала выбора адреса столбцов интегральной микросхемы
274. **Ток сигнала выбора адреса строк интегральной микросхемы** Ток сигнала выбора адреса строк	$I_{в.а.с}$	I_{RAS}	Ток в цепи сигнала выбора адреса строк интегральной микросхемы
275. **Динамическая потребляемая мощность интегральной микросхемы** Динамическая потребляемая мощность	$P_{пот.дин}$	P_{CCD}	Потребляемая мощность интегральной микросхемы в заданном динамическом режиме
276. **Потребляемая мощность в режиме хранения интегральной микросхемы** Потребляемая мощность в режиме хранения	$P_{пот.хр}$	P_{CCS}	Потребляемая мощность интегральной микросхемы в режиме хранения от источников питания
277. **Время выборки интегральной микросхемы** Время выборки E. Access time F. Temps d'accès	$t_в$	t_A	Интервал времени между подачей на вход интегральной микросхемы заданного сигнала и получением на выходе сигнала информации при условии, что все остальные необходимые сигналы поданы
278. **Время удержания сигнала интегральной микросхемы** Время удержания E. Hold time F. Temps de maintien	$t_у$	t_H	Интервал времени, в течение которого сигнал удерживается на заданном выводе входа после активного перехода на другом заданном выводе входа
279. **Время цикла записи информации интегральной микросхемы** Время записи информации	$t_{оп}$	t_{CYW}	Интервал времени, равный периоду сигнала на одном из входов, в течение которого интегральная микросхема осуществляет запись информации
280. **Время цикла считывания информации интегральной микросхемы** Время считывания	$t_{ач}$	t_{CYR}	Интервал времени, равный периоду сигнала на одном из входов, в течение которого интегральная микросхема осуществляет считывание информации

Продолжение табл. 1

Термин	Буквенное обозначение		Определение
	отечественное	международное	
281. **Время регенерации интегральной микросхемы** Время регенерации E. Refresh time interval F. Intervalle de temps de rafraîchissement	$t_{рег}$	t_{REF}	Интервал времени между началом последовательных сигналов, предназначенных для восстановления уровня в ячейке динамической интегральной микросхемы до его первоначального значения

Таблица 2

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Термин	Номер термина
Амплитуда выбросов напряжения на аналоговом выходе	144
Амплитуда выбросов напряжения на аналоговом выходе интегральной микросхемы	144
Время включения	141
Время включения интегральной микросхемы	141
Время выключения	142
Время выключения интегральной микросхемы	142
Время восстановления	182
Время восстановления интегральной микросхемы	182
Время восстановления по напряжению	114
Время восстановления по напряжению интегральной микросхемы	114
Время восстановления по току	115
Время восстановления по току интегральной микросхемы	115
Время выбора	177
Время выбора интегральной микросхемы	177
Время выборки	277
Время выборки интегральной микросхемы	277
Время готовности	113
Время готовности интегральной микросхемы	113
Время задержки включения	185
Время задержки включения интегральной микросхемы	185
Время задержки выключения	186
Время задержки выключения интегральной микросхемы	186
Время задержки	60
Время задержки импульса интегральной микросхемы	60
Время задержки распространения интегральной микросхемы среднее	205
Время задержки распространения при включении	183
Время задержки распространения при включении интегральной микросхемы	183
Время задержки распространения при выключении	184
Время задержки распространения при выключении интегральной микросхемы	184
Время задержки распространения при переходе из состояния «Выключено» в состояние низкого уровня	209
Время задержки распространения при переходе из состояния «Выключено» в состояние высокого уровня	208
Время задержки распространения при переходе из состояния высокого уровня в состояние «Выключено»	206
Время задержки распространения при переходе из состояния низкого уровня в состояние «Выключено»	207
Время задержки распространения среднее	205
Время записи информации	279
Время нарастания сигнала	30
Время нарастания сигнала интегральной микросхемы	30
Время переключения	143
Время переключения интегральной микросхемы	143

Продолжение табл. 2

Термин	Номер термина
Время перехода при включении	175
Время перехода при включении интегральной микросхемы	175
Время перехода при выключении	176
Время перехода при выключении интегральной микросхемы	176
Время регенерации	281
Время регенерации интегральной микросхемы	281
Время сохранения	178
Время сохранения сигнала интегральной микросхемы	178
Время спада сигнала	31
Время спада сигнала интегральной микросхемы	31
Время считывания	280
Время удержания	278
Время удержания интегральной микросхемы	278
Время успокоения	59
Время успокоения интегральной микросхемы	59
Время успокоения выходного напряжения	85
Время успокоения выходного напряжения интегральной микросхемы	85
Время установления входных сигналов	180
Время установления входных сигналов интегральной микросхемы	180
Время хранения информации	179
Время хранения информации интегральной микросхемы	179
Время цикла	181
Время цикла записи информации интегральной микросхемы	279
Время цикла интегральной микросхемы	181
Время цикла считывания информации интегральной микросхемы	280
Диапазон автоматической регулировки усиления интегральной микросхемы	69
Диапазон АРУ	69
Диапазон входных напряжений	90
Диапазон входных напряжений интегральной микросхемы	90
Диапазон выходных напряжений	107
Диапазон выходных напряжений интегральной микросхемы	107
Диапазон значений параметра	3
Диапазон значений параметра допустимый	4
Диапазон значений параметра интегральной микросхемы	3
Диапазон значений параметра интегральной микросхемы допустимый	4
Диапазон по напряжению динамический	98
Диапазон по напряжению интегральной микросхемы динамический	98
Диапазон регулировки коэффициента усиления мощности	97
Диапазон регулировки коэффициента усиления мощности интегральной микросхемы	97
Диапазон регулировки коэффициента усиления напряжения	97
Диапазон регулировки коэффициента усиления напряжения интегральной микросхемы	97
Диапазон регулировки коэффициента усиления тока	97

Продолжение табл. 2

Термин	Номер термина
Диапазон регулировки коэффициента усиления тока интегральной микросхемы	97
Длительность сигнала	187
Длительность сигнала высокого уровня	189
Длительность сигнала высокого уровня интегральной микросхемы	189
Длительность сигнала интегральной микросхемы	187
Длительность сигнала низкого уровня	188
Длительность сигнала низкого уровня интегральной микросхемы	188
Длительность спада входного сигнала	33
Длительность спада входного сигнала интегральной микросхемы	33
Длительность фронта входного сигнала	32
Длительность фронта входного сигнала интегральной микросхемы	32
Дрейф выходного напряжения	124
Дрейф выходного напряжения интегральной микросхемы	124
Дрейф выходного тока	125
Дрейф выходного тока интегральной микросхемы	125
Емкость аналогового входа	146
Емкость аналогового входа интегральной микросхемы	146
Емкость аналогового выхода	147
Емкость аналогового выхода интегральной микросхемы	147
Емкость входа/выхода	194
Емкость входа/выхода интегральной микросхемы	194
Емкость входная	27
Емкость выходная	28
Емкость интегральной микросхемы входная	27
Емкость интегральной микросхемы выходная	28
Емкость нагрузки	29
Емкость нагрузки интегральной микросхемы	29
Емкость между аналоговыми выходом и входом	148
Емкость между аналоговыми выходом и входом интегральной микросхемы	148
Емкость управляющего входа	145
Емкость управляющего входа интегральной микросхемы	145
Значение параметра интегральной микросхемы максимальное	10
Значение параметра интегральной микросхемы минимальное	11
Значение параметра интегральной микросхемы номинальное	2
Значение параметра максимальное	10
Значение параметра минимальное	11
Значение параметра номинальное	2
Коэффициент влияния нестабильности источников питания на напряжение смещения нуля	66
Коэффициент влияния нестабильности источников питания на напряжение смещения нуля интегральной микросхемы	66
Коэффициент входного тока временной	87
Коэффициент входного тока интегральной микросхемы временной	87

Продолжение табл. 2

Термин	Номер термина
Коэффициент выходного тока интегральной микросхемы температурный	126
Коэффициент выходного тока температурный	126
Коэффициент гармоник	68
Коэффициент гармоник интегральной микросхемы	68
Коэффициент деления частоты,	74
Коэффициент деления частоты интегральной микросхемы	74
Коэффициент интермодуляционных искажений	102
Коэффициент интермодуляционных искажений интегральной микросхемы	102
Коэффициент напряжения смещения нуля временной	89
Коэффициент напряжения смещения нуля интегральной микросхемы временной	89
Коэффициент нелинейности амплитудной характеристики	99
Коэффициент нелинейности амплитудной характеристики интегральной микросхемы	99
Коэффициент неравномерности амплитудно-частотной характеристики интегральной микросхемы	100
Коэффициент неравномерности АЧХ	100
Коэффициент объединения по входу	212
Коэффициент объединения по входу интегральной микросхемы	212
Коэффициент ослабления синфазных входных напряжений	65
Коэффициент ослабления синфазных входных напряжений интегральной микросхемы	65
Коэффициент параметра интегральной микросхемы температурный	8
Коэффициент параметра температурный	8
Коэффициент передачи	131
Коэффициент передачи интегральной микросхемы	131
Коэффициент передачи по напряжению	152
Коэффициент передачи по напряжению интегральной микросхемы	152
Коэффициент подавления сигнала между каналами	151
Коэффициент подавления сигнала между каналами интегральной микросхемы	151
Коэффициент подавления сигнала разомкнутым ключом	150
Коэффициент подавления сигнала разомкнутым ключом интегральной микросхемы	150
Коэффициент полезного действия	103
Коэффициент полезного действия интегральной микросхемы	103
Коэффициент прямоугольности амплитудно-частотной характеристики интегральной микросхемы	71
Коэффициент прямоугольности АЧХ	71
Коэффициент пульсаций	72
Коэффициент пульсаций интегральной микросхемы	72
Коэффициент разветвления по выходу	211
Коэффициент разветвления по выходу интегральной микросхемы	211
Коэффициент разделения каналов	86
Коэффициент разделения каналов интегральной микросхемы	86
Коэффициент разности входных токов временной	88

Продолжение табл. 2

Термин	Номер термина
Коэффициент разности входных токов интегральной микросхемы временной	88
Коэффициент сглаживания пульсаций	123
Коэффициент сглаживания пульсаций интегральной микросхемы	123
Коэффициент стабилизации входного напряжения	121
Коэффициент стабилизации входного напряжения интегральной микросхемы	121
Коэффициент стабилизации нагрузки	122
Коэффициент стабилизации нагрузки интегральной микросхемы	122
Коэффициент умножения частоты	73
Коэффициент умножения частоты интегральной микросхемы	73
Коэффициент усиления дифференциального сигнала по напряжению	67
Коэффициент усиления дифференциального сигнала по напряжению интегральной микросхемы	67
Коэффициент усиления мощности	63
Коэффициент усиления мощности интегральной микросхемы	63
Коэффициент усиления напряжения	61
Коэффициент усиления напряжения интегральной микросхемы	61
Коэффициент усиления синфазных входных напряжений	64
Коэффициент усиления синфазных входных напряжений интегральной микросхемы	64
Коэффициент усиления тока	62
Коэффициент усиления тока интегральной микросхемы	62
Коэффициент шума	101
Коэффициент шума интегральной микросхемы	101
Крутизна преобразования	75
Крутизна преобразования интегральной микросхемы	75
Крутизна проходной характеристики	104
Крутизна проходной характеристики интегральной микросхемы	104
Мощность в режиме хранения интегральной микросхемы потребляемая	276
Мощность в режиме хранения потребляемая	276
Мощность выходная	47
Мощность интегральной микросхемы выходная	47
Мощность интегральной микросхемы коммутируемая	130
Мощность интегральной микросхемы потребляемая	22
Мощность интегральной микросхемы потребляемая динамическая	275
Мощность интегральной микросхемы потребляемая средняя	204
Мощность интегральной микросхемы рассеиваемая	23
Мощность *i*-го источника питания интегральной микросхемы потребляемая	174
Мощность *i*-го источника питания потребляемая	174
Мощность коммутируемая	130
Мощность потребляемая	22
Мощность потребляемая динамическая	275

Продолжение табл. 2

Термин	Номер термина
Мощность потребляемая средняя	204
Мощность рассеиваемая	23
Напряжение автоматической регулировки усиления интегральной микросхемы	91
Напряжение АРУ	91
Напряжение блокировки входное	199
Напряжение блокировки интегральной микросхемы входное	199
Напряжение входное	13
Напряжение высокого уровня входное	155
Напряжение высокого уровня входное максимальное	215
Напряжение высокого уровня входное минимальное	217
Напряжение высокого уровня выходное	157
Напряжение высокого уровня выходное минимальное	219
Напряжение высокого уровня интегральной микросхемы входное	155
Напряжение высокого уровня интегральной микросхемы входное максимальное	215
Напряжение высокого уровня интегральной микросхемы входное минимальное	217
Напряжение высокого уровня интегральной микросхемы выходное	157
Напряжение высокого уровня интегральной микросхемы выходное минимальное	219
Напряжение высокого уровня интегральной микросхемы пороговое входное	197
Напряжение высокого уровня интегральной микросхемы пороговое выходное	195
Напряжение высокого уровня интегральной микросхемы управляющее	133
Напряжение высокого уровня пороговое входное	197
Напряжение высокого уровня пороговое выходное	195
Напряжение высокого уровня сигнала адреса	240
Напряжение высокого уровня сигнала адреса интегральной микросхемы	240
Напряжение высокого уровня сигнала входной информации	225
Напряжение высокого уровня сигнала входной информации интегральной микросхемы	225
Напряжение высокого уровня сигнала выбора	246
Напряжение высокого уровня сигнала выбора адреса столбцов	250
Напряжение высокого уровня сигнала выбора адреса столбцов интегральной микросхемы	250
Напряжение высокого уровня сигнала выбора адреса строк	253
Напряжение высокого уровня сигнала выбора адреса строк интегральной микросхемы	253
Напряжение высокого уровня сигнала выбора интегральной микросхемы	246
Напряжение высокого уровня сигнала выходной информации	228
Напряжение высокого уровня сигнала выходной информации интегральной микросхемы	228

Продолжение табл. 2

Термин	Номер термина
Напряжение высокого уровня сигнала записи	231
Напряжение высокого уровня сигнала записи интегральной микросхемы	231
Напряжение высокого уровня сигнала запись-считывание	243
Напряжение высокого уровня сигнала запись-считывание интегральной схемы	243
Напряжение высокого уровня сигнала разрешения	237
Напряжение высокого уровня сигнала разрешения интегральной микросхемы	237
Напряжение высокого уровня сигнала считывания	234
Напряжение высокого уровня сигнала считывания интегральной микросхемы	234
Напряжение высокого уровня управляющее	133
Напряжение выходное	14
Напряжение выходное максимальное	76
Напряжение гистерезиса	127
Напряжение гистерезиса интегральной микросхемы	127
Напряжение задержки автоматической регулировки усиления интегральной микросхемы	92
Напряжение задержки АРУ	92
Напряжение инжектора при заданном токе инжектора	213
Напряжение инжектора при заданном токе инжектора интегральной микросхемы	213
Напряжение интегральной микросхемы входное	13
Напряжение интегральной микросхемы выходное	14
Напряжение интегральной микросхемы выходное максимальное	76
Напряжение интегральной микросхемы коммутируемое	37
Напряжение интегральной микросхемы опорное	109
Напряжение интегральной микросхемы остаточное	43
Напряжение i-го источника питания	153
Напряжение i-го источника питания интегральной микросхемы	153
Напряжение коммутируемое	37
Напряжение низкого уровня входное	154
Напряжение низкого уровня входное максимальное	214
Напряжение низкого уровня входное минимальное	216
Напряжение низкого уровня выходное	158
Напряжение низкого уровня выходное максимальное	218
Напряжение низкого уровня интегральной микросхемы входное	154
Напряжение низкого уровня интегральной микросхемы входное максимальное	214
Напряжение низкого уровня интегральной микросхемы входное минимальное	216
Напряжение низкого уровня интегральной микросхемы выходное	158
Напряжение низкого уровня интегральной микросхемы выходное максимальное	218

Продолжение табл. 2

Термин	Номер термина
Напряжение низкого уровня интегральной микросхемы пороговое входное	198
Напряжение низкого уровня интегральной микросхемы пороговое выходное	196
Напряжение низкого уровня интегральной микросхемы управляющее	132
Напряжение низкого уровня пороговое входное	198
Напряжение низкого уровня пороговое выходное	196
Напряжение низкого уровня сигнала адреса	239
Напряжение низкого уровня сигнала адреса интегральной микросхемы	239
Напряжение низкого уровня сигнала входной информации	224
Напряжение низкого уровня сигнала входной информации интегральной микросхемы	224
Напряжение низкого уровня сигнала выбора	245
Напряжение низкого уровня сигнала выбора интегральной микросхемы	245
Напряжение низкого уровня сигнала выбора адреса столбцов	249
Напряжение низкого уровня сигнала выбора адреса столбцов интегральной микросхемы	249
Напряжение низкого уровня сигнала выбора адреса строк	252
Напряжение низкого уровня сигнала выбора адреса строк интегральной микросхемы	252
Напряжение низкого уровня сигнала выходной информации	227
Напряжение низкого уровня сигнала выходной информации интегральной микросхемы	227
Напряжение низкого уровня сигнала записи	230
Напряжение низкого уровня сигнала записи интегральной микросхемы	230
Напряжение низкого уровня сигнала запись-считывание	242
Напряжение низкого уровня сигнала запись-считывание интегральной микросхемы	242
Напряжение низкого уровня сигнала разрешения	236
Напряжение низкого уровня сигнала разрешения интегральной микросхемы	236
Напряжение низкого уровня сигнала считывания	233
Напряжение низкого уровня сигнала считывания интегральной микросхемы	233
Напряжение низкого уровня управляющее	132
Напряжение ограничения входное	42
Напряжение ограничения интегральной микросхемы входное	42
Напряжение опорное	109
Напряжение остаточное	43
Напряжение отпускания	16
Напряжение отпускания интегральной микросхемы	16
Напряжение питания	12
Напряжение питания в режиме хранения	222
Напряжение питания в режиме хранения интегральной микросхемы	222

Продолжение табл. 2

Термин	Номер термина
Напряжение питания интегральной микросхемы	12
Напряжение покоя входное	35
Напряжение покоя выходное	36
Напряжение покоя интегральной микросхемы входное	35
Напряжение покоя интегральной микросхемы выходное	36
Напряжение пульсаций источника питания	93
Напряжение пульсаций источника питания интегральной микросхемы	93
Напряжение сигнала адреса	238
Напряжение сигнала адреса интегральной микросхемы	238
Напряжение сигнала входной информации	223
Напряжение сигнала входной информации интегральной микросхемы	223
Напряжение сигнала выбора	244
Напряжение сигнала выбора адреса столбцов	248
Напряжение сигнала выбора адреса столбцов интегральной микросхемы	248
Напряжение сигнала выбора адреса строк	251
Напряжение сигнала выбора адреса строк интегральной микросхемы	251
Напряжение сигнала выбора интегральной микросхемы	244
Напряжение сигнала выходной информации	226
Напряжение сигнала выходной информации интегральной микросхемы	226
Напряжение сигнала записи	229
Напряжение сигнала записи интегральной микросхемы	229
Напряжение сигнала запись-считывание	241
Напряжение сигнала запись-считывание интегральной микросхемы	241
Напряжение сигнала программирования	255
Напряжение сигнала программирования интегральной микросхемы	255
Напряжение сигнала разрешения	235
Напряжение сигнала разрешения интегральной микросхемы	235
Напряжение сигнала стирания	254
Напряжение сигнала стирания интегральной микросхемы	254
Напряжение сигнала считывания	232
Напряжение сигнала считывания интегральной микросхемы	232
Напряжение синхронизации	128
Напряжение синхронизации интегральной микросхемы	128
Напряжение смещения нуля	38
Напряжение смещения нуля интегральной микросхемы	38
Напряжение срабатывания	15
Напряжение срабатывания интегральной микросхемы	15
Напряжение считывания обратной связи	108
Напряжение считывания обратной связи интегральной микросхемы	108
Напряжение тактового сигнала	247
Напряжение тактового сигнала интегральной микросхемы	247
Напряжение управления	7

Продолжение табл. 2

Термин	Номер термина
Напряжение управления интегральной микросхемы	7
Напряжение шума	77
Напряжение шума интегральной микросхемы	77
Напряжение шума интегральной микросхемы эффективное	78
Напряжение шума на выходе	39
Напряжение шума на выходе интегральной микросхемы	39
Напряжение шума, приведенное ко входу	40
Напряжение шума, приведенное ко входу интегральной микросхемы	40
Напряжение шума эффективное	78
Напряжения входные синфазные	41
Напряжения интегральной микросхемы входные синфазные	41
Нестабильность параметра	9
Нестабильность параметра интегральной микросхемы	9
Нестабильность по нагрузке	120
Нестабильность по нагрузке интегральной микросхемы	120
Нестабильность по напряжению	118
Нестабильность по напряжению взаимная	116
Нестабильность по напряжению интегральной микросхемы	118
Нестабильность по напряжению интегральной микросхемы взаимная	116
Нестабильность по току	119
Нестабильность по току взаимная	117
Нестабильность по току интегральной микросхемы	119
Нестабильность по току интегральной микросхемы взаимная	117
Отклонение параметра	5
Отклонение параметра интегральной микросхемы	5
Отклонение параметра интегральной микросхемы относительное	6
Отклонение параметра относительное	6
Отношение сигнал/шум	105
Отношение сигнал/шум интегральной микросхемы	105
Падение напряжения	110
Падение напряжения минимальное	111
Падение напряжения на антизвонном диоде интегральной микросхемы прямое	156
Падение напряжения на антизвонном диоде прямое	156
Падение напряжения на интегральной микросхеме	110
Падение напряжения на интегральной микросхеме минимальное	111
Параметр	3
Параметр интегральной микросхемы	3
Период следования импульсов тактовых сигналов	191
Период следования импульсов тактовых сигналов интегральной микросхемы	191
Полоса единичного усиления	56
Полоса задерживания	53
Полоса задерживания интегральной микросхемы	53
Полоса захвата синхронизации	129
Полоса захвата синхронизации интегральной микросхемы	129

Продолжение табл. 2

Термин	Номер термина
Полоса пропускания	52
Полоса пропускания интегральной микросхемы	52
Помехоустойчивость при высоком уровне	193
Помехоустойчивость при высоком уровне интегральной микросхемы	193
Помехоустойчивость при низком уровне	192
Помехоустойчивость при низком уровне интегральной микросхемы	192
Размах шума	79
Размах шума интегральной микросхемы	79
Разность входных токов	44
Разность входных токов интегральной микросхемы	44
Сдвиг интегральной микросхемы фазовый	106
Сдвиг фаз	106
Сдвиг фазовый	106
Сила шума интегральной микросхемы электродвижущая нормированная	80
Скорость нарастания выходного напряжения	70
Скорость нарастания выходного напряжения интегральной микросхемы	70
Скорость нарастания выходного напряжения интегральной микросхемы максимальная	82
Скорость нарастания выходного напряжения максимальная	82
Скорость отслеживания	70
Сопротивление в открытом состоянии	140
Сопротивление в открытом состоянии интегральной микросхемы	140
Сопротивление входное	24
Сопротивление выходное	25
Сопротивление интегральной микросхемы входное	24
Сопротивление интегральной микросхемы выходное	25
Сопротивление нагрузки	26
Сопротивление нагрузки интегральной микросхемы	26
Ток автоматической регулировки усиления интегральной микросхемы	91
Ток АРУ	91
Ток в состоянии «Выключено» выходной	165
Ток в состоянии «Выключено» интегральной микросхемы выходной	165
Ток входной	17
Ток входной пробивной	200
Ток входной средний	45
Ток высокого уровня в состоянии «Выключено» выходной	167
Ток высокого уровня в состоянии «Выключено» интегральной микросхемы выходной	167
Ток высокого уровня входной	162
Ток высокого уровня выходной	163
Ток высокого уровня интегральной микросхемы входной	162
Ток высокого уровня интегральной микросхемы выходной	163
Ток высокого уровня по входу выбора	269

Продолжение табл. 2

Термин	Номер термина
Ток высокого уровня по входу выбора интегральной микросхемы	269
Ток высокого уровня сигнала входной информации	259
Ток высокого уровня сигнала входной информации интегральной микросхемы	259
Ток высокого уровня сигнала выходной информации	262
Ток высокого уровня сигнала выходной информации интегральной микросхемы	262
Ток высокого уровня управляющего напряжения входной	137
Ток высокого уровня управляющего напряжения интегральной микросхемы выходной	137
Ток выходной	18
Ток инжектора	220
Ток инжектора интегральной микросхемы	220
Ток интегральной микросхемы входной	17
Ток интегральной микросхемы входной пробивной	200
Ток интегральной микросхемы входной средний	45
Ток интегральной микросхемы выходной	18
Ток интегральной микросхемы коммутируемый	46
Ток коммутируемый	46
Ток короткого замыкания	21
Ток короткого замыкания интегральной микросхемы	21
Ток низкого уровня в состоянии «Выключено» выходной	166
Ток низкого уровня в состоянии «Выключено» интегральной микросхемы выходной	166
Ток низкого уровня входной	161
Ток низкого уровня выходной	164
Ток низкого уровня интегральной микросхемы входной	161
Ток низкого уровня интегральной микросхемы выходной	164
Ток низкого уровня по входу выбора	268
Ток низкого уровня по входу выбора интегральной микросхемы	268
Ток низкого уровня сигнала входной информации	258
Ток низкого уровня сигнала входной информации интегральной микросхемы	258
Ток низкого уровня сигнала выходной информации	261
Ток низкого уровня сигнала выходной информации интегральной микросхемы	261
Ток низкого уровня управляющего напряжения входной	136
Ток низкого уровня управляющего напряжения интегральной микросхемы входной	136
Ток потребления	20
Ток потребления в режиме хранения	256
Ток потребления в режиме хранения интегральной микросхемы	256
Ток потребления в состоянии «Выключено»	221
Ток потребления в состоянии «Выключено» интегральной микросхемы	221
Ток потребления выходного напряжения высокого уровня	202

Продолжение табл. 2

Термин	Номер термина
Ток потребления выходного напряжения высокого уровня интегральной микросхемы	202
Ток потребления выходного напряжения низкого уровня	201
Ток потребления выходного напряжения низкого уровня интегральной микросхемы	201
Ток потребления динамический	160
Ток потребления интегральной микросхемы	20
Ток потребления интегральной микросхемы динамический	160
Ток потребления i-го источника питания	159
Ток потребления i-го источника питания интегральной микросхемы	159
Ток потребления при высоком уровне управляющего напряжения	139
Ток потребления при высоком уровне управляющего напряжения интегральной микросхемы	139
Ток потребления при низком уровне управляющего напряжения	138
Ток потребления при низком уровне управляющего напряжения интегральной микросхемы	138
Ток потребления средний	203
Ток потребления интегральной микросхемы средний	203
Ток сигнала адреса	265
Ток сигнала адреса интегральной микросхемы	265
Ток сигнала выбора	267
Ток сигнала выбора интегральной микросхемы	267
Ток сигнала выбора адреса столбцов	273
Ток сигнала выбора адреса столбцов интегральной микросхемы	273
Ток сигнала выбора адреса строк	274
Ток сигнала выбора адреса строк интегральной микросхемы	274
Ток сигнала входной информации	257
Ток сигнала входной информации интегральной микросхемы	257
Ток сигнала выходной информации	260
Ток сигнала выходной информации интегральной микросхемы	260
Ток сигнала записи	263
Ток сигнала записи интегральной микросхемы	263
Ток сигнала запись-считывание	266
Ток сигнала запись-считывание интегральной микросхемы	266
Ток сигнала разрешения	270
Ток сигнала разрешения интегральной микросхемы	270
Ток сигнала стирания	271
Ток сигнала стирания интегральной микросхемы	271
Ток сигнала считывания	264
Ток сигнала считывания интегральной микросхемы	264
Ток тактового сигнала	272
Ток тактового сигнала интегральной микросхемы	272
Ток управления	7
Ток управления интегральной микросхемы	7
Ток утечки	19
Ток утечки аналогового входа	134

Продолжение табл. 2

Термин	Номер термина
Ток утечки аналогового входа интегральной микросхемы	134
Ток утечки аналогового выхода	135
Ток утечки аналогового выхода интегральной микросхемы	135
Ток утечки высокого уровня на входе	171
Ток утечки высокого уровня на входе интегральной микросхемы	171
Ток утечки высокого уровня на выходе	**173**
Ток утечки высокого уровня на выходе интегральной микросхемы	173
Ток утечки интегральной микросхемы	19
Ток утечки на входе	168
Ток утечки на входе интегральной микросхемы	168
Ток утечки на выходе	169
Ток утечки на выходе интегральной микросхемы	**169**
Ток утечки низкого уровня на входе	170
Ток утечки низкого уровня на входе интегральной микросхемы	170
Ток утечки низкого уровня на выходе	172
Ток утечки низкого уровня на выходе интегральной микросхемы	172
Ток холостого хода	112
Ток холостого хода интегральной микросхемы	112
Ток шума нормированный	81
Ток шума интегральной микросхемы нормированный	81
Частота входного сигнала	**57**
Частота входного сигнала интегральной микросхемы	57
Частота генерирования	58
Частота генерирования интегральной микросхемы	58
Частота единичного усиления	**56**
Частота единичного усиления интегральной микросхемы	56
Частота интегральной микросхемы рабочая	210
Частота квазирезонанса	**96**
Частота квазирезонанса интегральной микросхемы	96
Частота коммутации	50
Частота коммутации интегральной микросхемы	50
Частота полной мощности	84
Частота полной мощности интегральной микросхемы	**84**
Частота полосы задерживания верхняя	55
Частота полосы задерживания интегральной микросхемы верхняя	55
Частота полосы задерживания интегральной микросхемы нижняя	54
Частота полосы задерживания нижняя	54
Частота полосы пропускания граничная верхняя	49
Частота полосы пропускания граничная нижняя	48
Частота полосы пропускания интегральной микросхемы граничная верхняя	49
Частота полосы пропускания интегральной микросхемы граничная нижняя	48

Продолжение табл. 2

Термин	Номер термина
Частота полосы пропускания интегральной микросхемы центральная	51
Частота полосы пропускания центральная	51
Частота рабочая	210
Частота резонанса	95
Частота резонанса интегральной микросхемы	95
Частота следования импульсов тактовых сигналов	190
Частота следования импульсов тактовых сигналов интегральной микросхемы	190
Частота среза	83
Частота среза интегральной микросхемы	83
Частота управляющего напряжения	149
Частота управляющего напряжения интегральной микросхемы	149
Чувствительность	34
Чувствительность интегральной микросхемы	34
ЭДС шума нормированная	80

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Таблица 3

Термин	Номер термина
Access time	277
Common-mode rejection ratio	65
Common-mode voltage amplification	64
Cycle time	181
Delay time	60
Differential-mode voltage amplification	67
Fall time	31
Feedback sense voltage	108
Frequency of unity (open loop) amplification	56
Hold time	278
Input offset voltage	
Input stabilization coefficient	38
Input transient current recovery time	121
Input transient voltage recovery time	115
Input voltage operating range	114
Load stabilization coefficient	90
Open-loop cut-off freguency	122
Output current drift	80
Output noise voltage	125
Output voltage drift	39
Output voltage operating range	124
Reference voltage	107
Refresh time interval	109
Ripple rejection ratio	281
Ripple time	123
Rise time	59
Set-up time	30
Short-circuit current	180
Valid time	21
	178

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ

Таблица 4

Термин	Номер термина
Amplification en tension en mode commun	64
Amplification en tension en mode différentiel	67
Coefficient de stabilisation en fonction de la charge	122
Coefficient de stabilisation en fonction de la tension d'entrée	121
Courant de court-circuit	
Dérive de la tension de sortie	21
Dérive du courant de sortie	124
Domaine de fonctionnement de la tension d'entrée	125
Domaine de fonctionnement de la tension de sortie	90
Fréquence de coupure en boucle ouverte	107
Fréquence pour l'amplification unité	83
Intervalle de temps de rafraîchissement	56
Taux de réjection en mode commun	281
Taux de réjection de l'ondulation résiduelle	65
Temps d'accès	123
Temps de croissance	277
Temps de cycle	30
Temps de décroissance	181
Temps de délai	31
Temps de maintien	60
Temps de préparation	278
Temps de recouvrement de la tension transitoire à l'entrée	180
Temps de recouvrement du courant transitoire à l'entrée	114
Temps de vacillement	115
Temps de validation	59
Tension de bruit en sortie	178
Tension de décalage	39
Tension de lecture de contre-réaction	38
Tension de référence	108
	109

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

МЕТОДИКА ОБРАЗОВАНИЯ БУКВЕННЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ ПРОИЗВОДИМЫХ ПАРАМЕТРОВ МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ И ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ ЗАПОМИНАЮЩИХ УСТРОЙСТВ

1. Для буквенных обозначений производных параметров используют следующий способ записи: $X_{yi;\ zj}$*,

где X — буквенное обозначение параметра, установленное настоящим стандартом;

y, z — подстрочные индексы буквенных обозначений входных и (или) выходных сигналов, приведенных в табл. 5;

i, j — цифровые индексы соответствующих входов и (или) выходов, равные 0, 1, 2, 3... n, где n — число входов и (или) выходов.

При однозначном понимании допускаются следующие сокращенные формы записи: $X_{y,\ z}$; X_{y1}; X_y; X.

Таблица 5

Наименование направления перехода сигнала	Обозначение	
	отечественное	международное
Для перехода из состояния низкого уровня в состояние высокого уровня	01	LH
Для перехода из состояния высокого уровня в состояние низкого уровня	10	HL

* Данный способ записи используют для микропроцессорных интегральных микросхем.

Для обозначений временных параметров сигналов необходимо использовать следующий способ записи: $t_{A_i(BC-DE)F}$,

где t_A — вид временного параметра;

i — порядковый номер параметра (1,2... n);

B — наименование сигнала в соответствии с перечнем, приведенным в табл. 6, состояние которого изменяется первым;

C — направление перехода сигнала B;

D — наименование сигнала в соответствии с перечнем, приведенным в табл. 6, состояние которого изменяется последним, т. е. в конце временного интервала;

E — направление перехода сигнала D;

F — дополнительная информация в соответствии с перечнем, приведенным в табл. 9.

Для направления перехода сигнала C и E используют обозначения в соответствии с табл. 5.

При однозначном понимании допускается первый индекс в обозначении направления перехода сигнала C и E опускать.

Таблица 5

Наименование сигнала	Обозначение	
	отечественное	международное
СИГНАЛЫ, ОБЩИЕ ДЛЯ МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ И ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ ЗАПОМИНАЮЩИХ УСТРОЙСТВ		
1. Адрес	а	A
2. Выбор микросхемы	в.м	CS
3. Запись	зп	WR
4. Считывание (чтение)	сч	RD
5. Тактовый	т	C
6 Разрешение	р	CE
7. Запись-считывание	зп.сч	WR/RD
8. Адрес-данные	а.д	AD
СИГНАЛЫ, ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ		
9. Авария источника питания	а.и.п	PSB
10. Авария сети питания	а.с.п	PNB
11 Арифметический сдвиг	а.с.д	AS
12. Асинхронный	асх	ASYN
13. Вектор	вс	REC
14. Внешний	вн	EXT
15. Вывод для подключения кварцевого резонатора	К1	BQ1
	К2	BQ2
16. Выход	вых	O
17. Вход	вх	I
18. Блокировка	бл	DE
19. Ведомый	вдм	SV
20. Ведущий	вдщ	MS
21. Восстановление	вс	REC
22. Вычитание	вч	SUB
23. Генерация	ге	GEN
24. Готовность	гт	RA
25. Графический символ	гс	GRS
26. Данные	д	D
27. Деление	дл	DIV
28. Декремент 1	—1	DEC1
29. Декремент 2	—2	DEC2
30. Доступ	дс	AC
31. Запрос	зпр	RQ
32. Захват	зм	BR
33. Зависание	звс	HG
34. Задатчик	зд	DR
35. Захват	зх	TR
36. Знак	зн	SI
37. Инкремент 1	+1	INC1
38. Инкремент 2	+2	INC2
39. Инкремент 1/Декремент 1	+1/—1	INC1/DEC1
40. Исполнитель	исп	PF

Продолжение табл. 6

Наименование сигнала	Обозначение	
	отечественное	международное
41. Инструкция (команда)	км	INS
42. Канал (шина)	кн	B
43. Канал занят	к.зт	BUSY
44. Квитирование	кв	AK
45. Конец	к	END
46. Код	код	CODE
47. Логический сдвиг	л.с	LSH
48. Логическая операция	л.о	LOP
49. Маркер	мр	MR
50. Маскирование	мс	MK
51. Микрооперация	моп	MOP
52. Микрокоманда	мк	MINS
53. Младший	мл	LSB
54. Множитель	множ	MPLX
55. Множимое	мже	MPLY
56. Максимальный	max	MX
57. Минимальный	min	MN
58. Начало исполнения команды	нк	STINS
59. Начало исполнения микрокоманды	н.мк	NMKINR
60. Немаскируемое прерывание	н.пр	NMK
61. Нуль	нул	Z
62. Ожидание	жд	WT
63. Останов	ост	HLT
64. Обратный ход	об.х	RVM
65. Операция	оп	OP
66. Ответ	отв	AN
67. Ошибка	ош	ER
68. Перенос	пс	CR
69. Переполнение	пп	CF
70. Передача	пч	T
71. Подтверждение	п	ACK
72. Прямой доступ к памяти	п.д.п	DMA
73. Повтор	пвт	RP
74. Продолжение	прд	CN
75. Предварительный заряд	п.з	PSH
76. Приоритет	пт	PR
77. Прием	пм	R
78. Прерывание	пр	INR
79. Пуск	пск	ST
80. Порт	п	P
81. Расширение	рш	EX
82. Распространение переноса	рпс	SPCR
83. Равенство нулю	р.н	ZR
84. Регистр команд	р.к	RGINS
85. Режим	реж	MO
86. Регистр микрокоманд	р.мк	RGMINS
87. Результат	рез	RZ
88. Сброс	сбр	SR
89. Сдвиг	сд	SH

Продолжение табл. 6

Наименование сигнала	Обозначение	
	отечественное	международное
90. Сдвиг влево	сд.л	SHL
91. Сдвиг вправо	сд.п	SHR
92. Синхронизация	с	SYN
93. Состояние	сс	SA
94 Строб	ст	ST
95. Сложение	сл	SM
96. Строка	стр	R
97. Следующий	слд	NEXT
98. Стек	ск	SK
99. Старший	ср	MSB
100. Средний	сд	ML
101. Тактовый вход	т.в	CI
102. Тактовый выход	т.вых	CO
103. Тестирование (проверка)	т	TEST
104. Условие	усл	CC
105 Условный бит (флаг)	ус.б	PL
106. Управление	упр	CN
107. Ускоренный перенос	уск.п	RCR
108. Установка в состояние *л*	уст	Sn
109. Умножение	умн	MPL
110. Управление	у	CO
111. Цикл	цкл	CY
112. Циклический сдвиг	ц.сд	CYSH
113. Чтение	чт	RD
114. Фаза	ф	F
115. Экран	э	RT

СИГНАЛЫ, ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ ЗАПОМИНАЮЩИХ УСТРОЙСТВ

116. Выбор адреса строки	в.а.с.	RAS
117. Выбор адреса столбца	в.а.к	CAS
118. Входная информация	вх.и	D
119. Выходная информация	вых.и	Q
120. Входная/выходная информация	вх и/вых.и	DQ
121. Запись-считывание	зп/сч	WR
122. Разрешение выхода	р.вых	OE
123. Программирование	прг	PR

2. Для микросхем с тремя состояниями на выходе для направления перехода сигнала С и Е используют обозначения в соответствии с табл. 7.

Таблица 7

Наименование направления перехода сигнала	Обозначение	
	отечественное	международное
Для перехода из третьего состояния в состояние высокого уровня	31	ZN
Для перехода из состояния высокого уровня в третье состояние	13	HZ
Для перехода из состояния низкого уровня в третье состояние	03	LZ
Для перехода из третьего состояния в состояние низкого уровня	30	ZL

При однозначном понимании допускается использовать сокращенные формы записи для временных параметров сигналов:

$$t_{A(B-D)};\ t_{A(B)};\ t_A.$$

3. Примеры обозначения производных параметров и их буквенных обозначений приведены в табл. 8.

Таблица 8

Наименование параметра	X (t_A)		$_{yi, zj}$ (B—D)		Производное обозначение $X_{yi, zj}$ ($t_{A(B-D)}$)	
	отечественное	международное	отечественное	международное	отечественное	международное
1. Входное напряжение низкого уровня сигнала прерывания	$U^0_{вх}$	U_{IL}	пр	INR	$U^0_{вх.пр}$	$U_{IL\ INR}$
2. Выходное напряжение высокого уровня сигнала синхронизации третьего канала	$U^1_{вых}$	U_{OH}	с.кнЗ	SYN, B3	$U^1_{вых.с\ кнЗ}$	$U_{OH\ SYN-B3}$
3. Максимальное входное напряжение высокого уровня сигнала маскирования 1-го разряда	$U^1_{вх}$	U_{IH}	max мс1	max MK1	$U^1_{вх\ max\ мс1}$	$U_{IH\ max\ MK1}$
4. Время установления сигнала квитирования «Принято» относительно сигнала «Выдача»	$t_{ус}$	t_{SU}	(кп-вд)	(TR-RCAK)	$t_{ус(кп-вд)}$	$t_{SU(TR-RCAK)}$
5. Время сохранения сигнала адреса относительно сигнала данных	$t_{сх}$	t_U	(д-а)	(D-A)	$t_{сх(д-а)}$	$t_{U(D-A)}$

Таблица 9

Режим работы	Буквенное обозначение	
	отечественное	международное
Запись	зп	WR
Считывание	сч	RD
Считывание-запись	сч/зп	RD/WR
Запись-считывание	зп/сч	WR/RD
Считывание по страницам	сч.стр	P
Слоговый режим	сл.р	N
Запись по страницам	зп.стр	PW
Считывание-модификация-запись	сч.м.зп	RMW
Регенерация	рг	REF
Программирование	прг	PR
Стирание	с т	ER

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством электронной промышленности СССР

   РАЗРАБОТЧИКИ

   Л. Р. Хворостьян, В. Ф. Марушкин, Е. Ф. Мещанкин, Ю. В. Назаров, Л. С. Жирякова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 21.12.89 № 3960

3. Срок первой проверки — 1996 г.,
   периодичность проверки — 5 лет

4. Стандарт соответствует Публикациям МЭК 748—1, МЭК 748—2, МЭК 748-3 в части терминов, определений и буквенных обозначений параметров и СТ СЭВ 1817—88, СТ СЭВ 4755—84, СТ СЭВ 4756—84

5. ВЗАМЕН ГОСТ 19480—74

Редактор *Л. Д. Курочкина*
Технический редактор *О. Н. Никитина*
Корректор *М. С. Кабашова*

gost.e-ecolog.ru

Подп. в печ. 22.05.00 4,5 усл. п. л. 4,5 усл. кр.-отт. 5,73 уч.-изд. л.
Тир. 19000 Цена 1р. 10 к.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер. 6. Зак. 1628